

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-116546

(P2002-116546A)

(43) 公開日 平成14年4月19日 (2002. 4. 19)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テームコード [*] (参考)
G 0 3 F 7/039	6 0 1	G 0 3 F 7/039	6 0 1 2 H 0 2 5
C 0 7 C 381/12		C 0 7 C 381/12	4 H 0 0 6
C 0 7 D 333/46		C 0 7 D 333/46	
G 0 3 F 7/004	5 0 3	G 0 3 F 7/004	5 0 3 A
H 0 1 L 21/027		H 0 1 L 21/30	5 0 2 R
審査請求 未請求 請求項の数10 O L (全 28 頁)			

(21) 出願番号 特願2001-184546 (P2001-184546)

(22) 出願日 平成13年6月19日 (2001. 6. 19)

(31) 優先権主張番号 特願2000-189120 (P2000-189120)

(32) 優先日 平成12年6月23日 (2000. 6. 23)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000002093

住友化学工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

(72) 発明者 上谷 保則

大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住

友化学工業株式会社内

(72) 発明者 大橋 賢治

大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住

友化学工業株式会社内

(74) 代理人 100093285

弁理士 久保山 隆 (外2名)

最終頁に続く

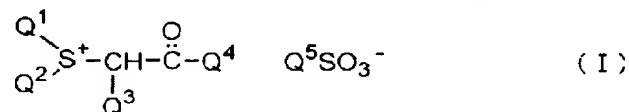
(54) 【発明の名称】 化学増幅型ポジ型レジスト組成物及びスルホニウム塩

(57) 【要約】

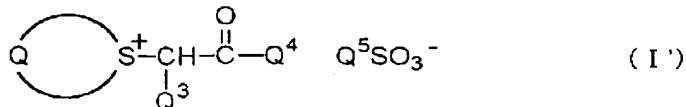
【課題】 感度や解像度などの各種のレジスト性能が良好であるとともに、特に改善されたラインエッジラフネスを与える化学増幅型ポジ型レジスト組成物。

【解決手段】 酸に不安定な基を持つ重合単位を有し、それ自身はアルカリに不溶又は難溶であるが、酸の作用でアルカリに可溶となる樹脂及び酸発生剤を含有する化学

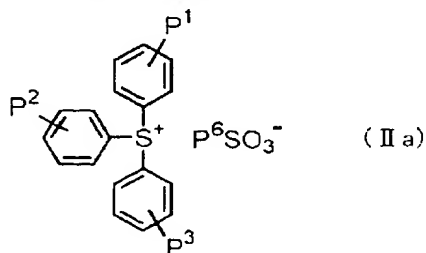
増幅型ポジ型レジスト組成物であって、該酸発生剤として、下式 (I) で示されるスルホニウム塩



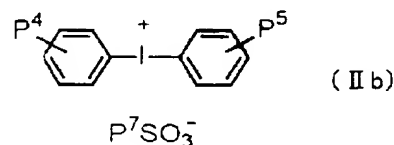
及び下式 (I') で示されるスルホニウム塩



から選ばれる少なくとも1種のスルホニウム塩と、



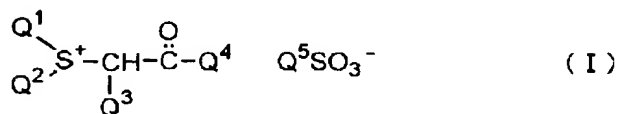
及び



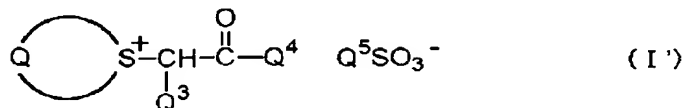
から選ばれる少なくとも1種のカニウム塩とを併用する

【特許請求の範囲】

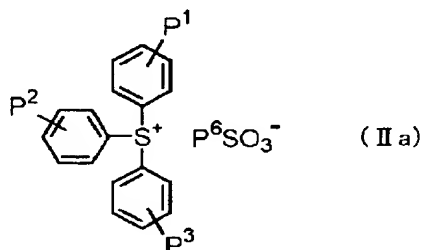
【請求項1】下式(I)で示されるスルホニウム塩及び下式(I')で示されるスルホニウム塩



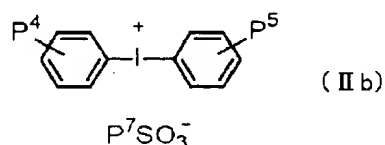
(式中、Q¹、Q²は、互いに独立に、炭素数1～6のアルキル基、又は炭素数3～10のシクロアルキル基を表*



(式中、Qは、記載のS⁺とともに環を完成する炭素数3～7の脂環式炭化水素基を表す。該脂環式炭化水素基は、ケトン基を有していてもよく、また該脂環式炭化水素基の少なくとも1個の-CH₂-が酸素原子もしくは硫黄原子に置換されていてもよい。Q³は、水素原子を表し、Q⁴は炭素数1～6のアルキル基、炭素数3～10のシクロアルキル基を表すか、又はQ³とQ⁴が隣接するCHC(O)基と一緒に2-オキシシクロアルキル基を表す。Q⁵SO₃⁻は有機スルホナートイオンを表す。)から選ばれる少なくとも1種のスルホニウム塩と、下式(IIa)で示されるトリフェニルスルホニウム塩及び下式(IIb)で示されるジフェニルヨードニウム塩



(式中、P¹～P³は、互いに独立に、水素、水酸基、炭素数1～6のアルキル基又は炭素数1～6のアルコキシ基を表し、P⁶SO₃⁻は、有機スルホナートイオンを表す。)



(式中、P⁴、P⁵は、互いに独立に、水素、水酸基、炭素数1～6のアルキル基又は炭素数1～6のアルコキシ基を表し、P⁷SO₃⁻は、有機スルホナートイオンを表す。)から選ばれる少なくとも1種のオニウム塩とを含む酸発生剤、並びに、酸に不安定な基を持つ重合単位を

*す。Q³は、水素原子を表し、Q⁴は炭素数1～6のアルキル基、炭素数3～10のシクロアルキル基を表すか、又はQ³とQ⁴が隣接するCHC(O)基と一緒に2-オキシシクロアルキル基を表す。Q⁵SO₃⁻は有機スルホナートイオンを表す。但し、Q⁵が炭素数1～8のパーフルオロアルキル基を表す場合は、Q³とQ⁴が隣接するCHC(O)基と一緒に2-オキシシクロヘキシル基を表す場合を除く。)

有し、それ自身はアルカリに不溶又は難溶であるが、酸の作用でアルカリに可溶となる樹脂を含有することを特徴とする化学増幅型ポジ型レジスト組成物。

【請求項2】式(I)におけるQ⁵、式(I')におけるQ⁵、式(IIa)におけるP⁶及び式(IIb)におけるP⁷が、互いに独立に、炭素数1～8のパーフルオロアルキル基、炭素数1～8のアルキル基、炭素数6～12の芳香族基又はカンファー基を表す請求項1記載の組成物。

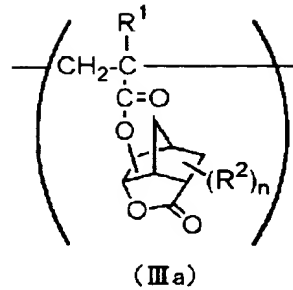
【請求項3】式(I)で示されるスルホニウム塩及び式(I')で示されるスルホニウム塩とから選ばれる少なくとも1種のスルホニウム塩と、式(IIa)のトリフェニルスルホニウム塩及び式(IIb)のジフェニルヨードニウム塩とから選ばれる少なくとも1種のオニウム塩とが、9:1～1:9の重量割合で存在する請求項1又は2記載の組成物。

【請求項4】樹脂中の酸に不安定な基を持つ重合単位の含有率が、10～80モル%である請求項1～3のいずれかに記載の組成物。

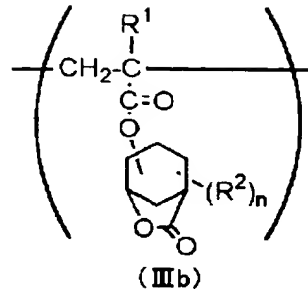
【請求項5】樹脂中の酸に不安定な基を持つ重合単位が、(メタ)アクリル酸2-アルキル-2-アダマンチル、(メタ)アクリル酸1-(1-アダマンチル)-1-アルキルアルキルの重合単位である請求項1～4のいずれかに記載の組成物。

【請求項6】樹脂がさらに、p-ヒドロキシスチレンの重合単位、m-ヒドロキシスチレンの重合単位、(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチルの重合単位、(メタ)アクリル酸3、5-ジヒドロキシ-1-アダマンチルの重合単位、ラクトン環がアルキルで置換されていてもよい(メタ)アクリロイロキシ-γ-ブチロラクトンの重合単位、及び下式(IIIa)、(IIIb)で示される脂環式ラクトンの重合単位、から選ばれる少なくとも1種の重合単位を含有する請求項1～5のいずれかに記載の組成物

3



4



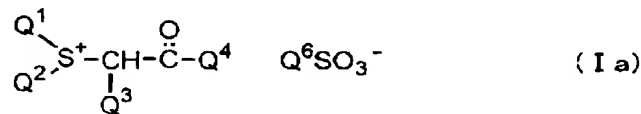
(式中、 R^1 、 R^2 は、互いに独立に水素、メチル又はトリフルオロメチルを表し、 n は1～3の数を表す。)

【請求項7】樹脂がさらに2-ノルボルネンの重合単位と脂肪族不飽和ジカルボン酸無水物の重合単位とを有す*

10*る請求項6記載の組成物。

【請求項8】さらに、アミン類をクエンチャーとして含有する請求項1～7のいずれかに記載の組成物。

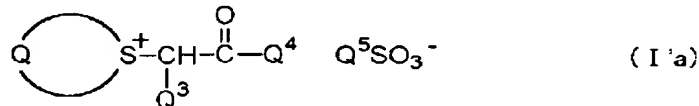
【請求項9】式(Ia)



(式中、 Q^6 は、炭素数1～8のパーフルオロアルキル基、炭素数1～8のアルキル基、炭素数6～12の芳香族基又はカンファー基を表す。 Q^6 が、炭素数1～8のパーフルオロアルキル基を表す場合は、 Q^1 、 Q^2 は、互いに独立に、炭素数1～6のアルキル基、炭素数3～10のシクロアルキル基を表す。 Q^3 は水素原子を、 Q^4 は炭素数1～6のアルキル基、炭素数3～10のシクロアルキル基を表す。 Q^6 が、炭素数1～8のアルキル基、※

※炭素数6～12の芳香族基又はカンファー基を表す場合は、 Q^1 、 Q^2 は、互いに独立に、炭素数1～6のアルキル基、炭素数3～10のシクロアルキル基を表す。 Q^3 は水素原子を、 Q^4 は炭素数1～6のアルキル基、炭素数3～10のシクロアルキル基を表すか、又は Q^3 と Q^4 が隣接するCHC(O)基と一緒に2-オキソシクロアルキル基を表す。)で示されるスルホニウム塩。

【請求項10】式(I'a)



(式中、 Q は、記載の S^+ とともに環を完成する炭素数3～7の脂環式炭化水素基を表す。該脂環式炭化水素基は、ケトン基を有していてもよく、また該脂環式炭化水素基の少なくとも1個の $-CH_2-$ が酸素原子もしくは硫黄原子に置換されていてもよい。 Q^3 は、水素原子を表し、 Q^4 は炭素数1～6のアルキル基、炭素数3～10のシクロアルキル基を表すか、又は Q^3 と Q^4 が隣接するCHC(O)基と一緒に2-オキソシクロアルキル基を表す。 $Q^5SO_3^-$ は有機スルホナートイオンを表す。)で示されるスルホニウム塩。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体の微細加工に用いられる化学増幅型のポジ型レジスト組成物に関するものである

【0002】

【従来の技術】半導体の微細加工には通常、レジスト組成物を用いたリソグラフィプロセスが採用されており、リソグラフィにおいて、レイリー(Rayleigh)の回折限界の式で表されるように、原理的には露光波長が短いほど解像度を上げることが可能である。半導体の製造に

30 用いられるリソグラフィ用露光光源は、波長436nmのg線、波長365nmのi線、波長248nmのKrFエキシマレーザー、波長193nmのArFエキシマレーザーと、年々短波長になってきており、次世代の露光光源として、波長157nmのF₂エキシマレーザーが有望視され、その後は波長13nm以下の軟X線(EUV)が光源として提案されている。

【0003】エキシマレーザー等の、g線、i線より短い波長の光源は照度が低いため、レジストの感度を高める必要があることから、露光により発生する酸の触媒作用を利用し、その酸により解裂する基を有する樹脂を含有するいわゆる化学増幅型レジストが用いられる。

【0004】しかしながら、従来公知の化学増幅型レジスト組成物では、定在波の発生等によりラインエッジラフネスすなわちパターン側壁の平滑性が低下する結果、線幅の均一性が悪くなるという問題点が生じる。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、樹脂成分と酸発生剤を含有し、ArFやKrFなどのエキシマレーザーリソグラフィに適した化学増幅型のポジ型レジスト組成物であって、感度や解像度などの各種のレジ

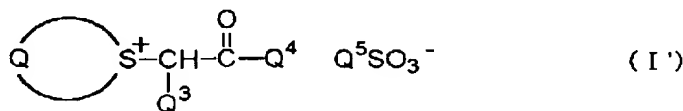
50

スト性能が良好であるとともに、特に改善されたラインエッジラフネスを与えるポジ型レジスト組成物を提供することにある。

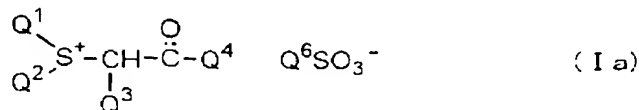
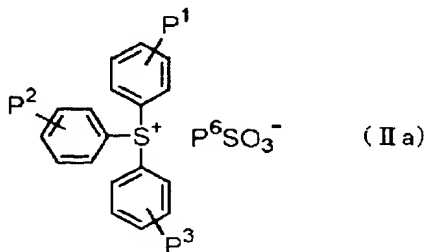
【0006】本発明者らは、既に、酸発生剤として、トリフェニルスルホニウム塩及びジフェニルヨードニウム塩から選ばれる少なくとも1種のオニウム塩に、シクロヘキシルメチル(2-オキソスルホニウム)パーフルオロアルキルスルホネート等の2-オキソスルホニウムのパーフルオロアルキルスルホネート塩を併用することにより、解像度が改良され、また塩基性基板や低反射率基板におけるプロファイルも改良されることを見出し提案している(特願2000-060057号)。更に検討を加えた結果、2-オキソスルホニウムのパーフルオロアルキルスルホネート塩の代わりに特定のスルホニウム塩を併用することにより、ラインエッジラフネスを改善し得ることを見出し、本発明を完成した。

【0007】

【課題を解決するための手段】すなわち、本発明は、下式(I)で示されるスルホニウム塩及び下式(I')

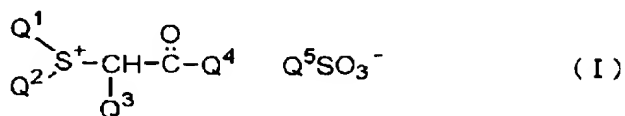


(式中、Qは、記載のS⁺とともに環を完成する炭素数3～7の脂環式炭化水素基を表す。該脂環式炭化水素基は、ケトン基を有していてもよく、また該脂環式炭化水素基の少なくとも1個の-CH₂-が酸素原子もしくは硫黄原子に置換されていてもよい。Q³は、水素原子を表し、Q⁴は炭素数1～6のアルキル基、炭素数3～10のシクロアルキル基を表すか、又はQ³とQ⁴が隣接するCHC(O)基と一緒に2-オキソシクロアルキル基を表す。Q⁵SO₃⁻は有機スルホネートイオンを表す。)から選ばれる少なくとも1種のスルホニウム塩と、下式(IIa)で示されるトリフェニルスルホニウム塩及び下式(IIb)で示されるジフェニルヨードニウム塩



(式中、Q¹は、炭素数1～8のパーフルオロアルキル基、炭素数1～8のアルキル基、炭素数6～12の芳香族

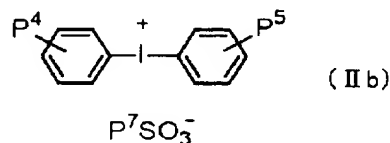
で示されるスルホニウム塩



(式中、Q¹、Q²は、互いに独立に、炭素数1～6のアルキル基、又は炭素数3～10のシクロアルキル基を表す。Q³は、水素原子を表し、Q⁴は炭素数1～6のアルキル基、炭素数3～10のシクロアルキル基を表すか、又はQ³とQ⁴が隣接するCHC(O)基と一緒に2-オキソシクロアルキル基を表す。Q⁵SO₃⁻は有機スルホネートイオンを表す。但し、Q⁵が炭素数1～8のパーフルオロアルキル基を表す場合は、Q¹が炭素数1～6のアルキル基を表し、Q²が炭素数1～6のアルキル基又は炭素数3～10のシクロアルキル基を表し、Q³とQ⁴が隣接するCHC(O)基と一緒に2-オキソシクロヘキシル基を表す場合を除く。)

【0008】

(式中、P¹～P³は、互いに独立に、水素、水酸基、炭素数1～6のアルキル基又は炭素数1～6のアルコキシ基を表し、P⁶SO₃⁻は、有機スルホネートイオンを表す。)

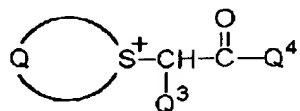


(式中、P⁴、P⁵は、互いに独立に、水素、水酸基、炭素数1～6のアルキル基又は炭素数1～6のアルコキシ基を表し、P⁷SO₃⁻は、有機スルホネートイオンを表す。)から選ばれる少なくとも1種のオニウム塩を含む酸発生剤、並びに、酸に不安定な基を持つ重合単位を有し、それ自身はアルカリに不溶又は難溶であるが、酸の作用でアルカリに可溶となる樹脂を含有する実用的に優れた化学増幅型ポジ型レジスト組成物を提供するものである。

【0009】また、本発明は、式(Ia)

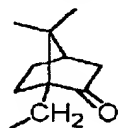
族基又はランフラー基を表す。Q⁵が、炭素数1～8のパーフルオロアルキル基を表す場合は、Q¹、Q²は、互

いに独立に、炭素数1～6のアルキル基、炭素数3～10のシクロアルキル基を表す。Q³は水素原子を、Q⁴は炭素数1～6のアルキル基、炭素数3～10のシクロアルキル基を表す。Q⁵が、炭素数1～8のアルキル基、炭素数6～12の芳香族基又はカンファー基を表す場合は、Q¹、Q²は、互いに独立に、炭素数1～6のアルキル基、炭素数3～10のシクロアルキル基を表す。Q³ *



(I'a)

(式中、Qは、記載のS⁺とともに環を完成する炭素数3～7の脂環式炭化水素基を表す。該脂環式炭化水素基は、ケトン基を有していてもよく、また該脂環式炭化水素基の少なくとも1個の-CH₂-が酸素原子もしくは硫黄原子に置換されていてもよい。Q³は、水素原子を表し、Q⁴は炭素数1～6のアルキル基、炭素数3～10のシクロアルキル基を表すか、又はQ³とQ⁴が隣接するCHC(O)基と一緒に2-オキシシクロアルキル基を表す。Q⁵SO₃⁻は有機スルホナートイオンを表す。)で示されるスルホニウム塩を提供する。ここで、カンファー基とは、下記の基をいう。



【0011】

【発明の実施の形態】化学増幅型のレジスト組成物に用いられる酸発生剤は、その物質自体に、あるいはその物質を含むレジスト組成物に、光や電子線などの放射線を作用させることにより、その物質が分解して酸を発生するものである。本発明における組成物では、かかる酸発生剤として、前記式(I)で示されるスルホニウム塩及び前記式(I')で示されるスルホニウム塩から選ばれる少なくとも1種のスルホニウム塩と、前記式(IIa)で示されるトリフェニルスルホニウム塩及び前記式(IIb)で示されるジフェニルヨードニウム塩から選ばれる少なくとも1種のオニウム塩とを併用する。

【0012】式(I)において、Q¹、Q²は、互いに独立に炭素数1～6のアルキル基、又は炭素数3～10のシクロアルキル基であることができ、炭素数3以上の場合は、直鎖でも分岐していてもよい。具体的なアルキル基、シクロアルキル基の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基などが挙げられる。また、式(I)において、Q³は水素原子を、Q⁴は炭素数1～6の直鎖もしくは分岐のアルキル基、炭素数3～10のシクロアルキル基を表すか、又はQ³とQ⁴が隣接するCHC(O)基と一緒に2-

オキシシクロアルキル基を表すことができる。Q⁴における具体的なアルキル基、シクロアルキル基の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基などが挙げられる。Q³とQ⁴が隣接するCHC(O)基と一緒に2-オキシシクロアルキル基を表すことができる場合、このような2-オキシシクロアルキル基としては、例えば2-オキシシクロヘキシル基、2-オキシシクロペンチル基、カンファー基などが挙げられる。

【0010】さらに、本発明は、式(I'a)

2-オキシシクロアルキル基を表すことができる。Q⁴における具体的なアルキル基、シクロアルキル基の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基などが挙げられる。Q³とQ⁴が隣接するCHC(O)基と一緒に2-オキシシクロアルキル基を表すことができる場合、このような2-オキシシクロアルキル基としては、例えば2-オキシシクロヘキシル基、2-オキシシクロペンチル基、カンファー基などが挙げられる。

【0013】また、式(I)において、Q⁵SO₃⁻は有機スルホナートイオンを表す。ここで、Q⁵は、炭素数1～12程度の有機基であれば良く、例えば炭素数1～8のパーフルオロアルキル基、炭素数1～8のアルキル基、炭素数6～12の芳香族基、カンファー基であることができる。パーフルオロアルキル基に該当する具体例としては、トリフルオロメチル基、パーフルオロブチル基、パーフルオロオクチル基などが挙げられ、炭素数1～8のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、オクチル基などが挙げられ、芳香族基としては、フェニル基、トリル基、キシリル基、メジチル基、ナフチル基などが挙げられる。

【0014】次に、式(I')において、Qは、記載のS⁺とともに環を完成する炭素数5～7の脂環式炭化水素基を表す。該脂環式炭化水素基は、ケトン基を有していてもよく、また該脂環式炭化水素基の少なくとも1個の-CH₂-が酸素原子もしくは硫黄原子に置換されていてもよい。記載の硫黄原子とともに環を完成する炭素数5～7の脂環式炭化水素としては、テトラヒドロチオフェン、チオキサン、ジチアン、テトラヒドロチオフェン-3-オン、テトラヒドロチオピラン-4-オンなどが挙げられる。これらのうち、式(I')で示される脂環式炭化水素基を有するスルホニウム塩が熱安定性の点で好ましい。該スルホニウム塩を用いると、ベーク温度(PEB温度)を上げることが可能となり、ラインエッジラフネスが良くなるので好ましい。

【0015】式(I')において、Q³は、水素原子を表し、Q⁴は炭素数1～6のアルキル基、炭素数3～10のシクロアルキル基を表すか、又はQ³とQ⁴が隣接するCHC(O)基と一緒に2-

ーオキシヘキシル) スルホニウム トリフルオロメタン
スルホナート、ジブチル (2-オキシヘブチル) スルホ
ニウム トリフルオロメタンスルホナート、ジブチル

(2-オキシオクチル) スルホニウム トリフルオロメ
タンスルホナート、ジブチル (3-メチル-2-オキシ
ブチル) スルホニウム トリフルオロメタンスルホナ
ート、ジブチル (3,3-ジメチル-2-オキシブチル) ス
ルホニウム トリフルオロメタンスルホナート、ジブチ
ル (2-シクロヘキシル-2-オキソエチル) スルホ
ニウム トリフルオロメタンスルホナート、ジブチル

(2-シクロペンチル-2-オキソエチル) スルホニ
ウム トリフルオロメタンスルホナート、ジイソプロピ
ル (2-オキシプロピル) スルホニウム トリフルオロ
メタンスルホナート、ジイソプロピル (2-オキシブ
チル) スルホニウム トリフルオロメタンスルホナート、
ジイソプロピル (2-オキシペンチル) スルホニウム
トリフルオロメタンスルホナート、ジイソプロピル (2
-オキシヘキシル) スルホニウム トリフルオロメタン
スルホナート、ジイソプロピル (2-オキシヘブチル)
スルホニウム トリフルオロメタンスルホナート、ジイ
ソプロピル (2-オキシオクチル) スルホニウム トリ
フルオロメタンスルホナート、ジイソプロピル (3-メ
チル-2-オキシブチル) スルホニウム トリフルオロ
メタンスルホナート、

【0025】3,3-ジメチル-2-オキシブチル ジ
イソプロピル スルホニウム トリフルオロメタンスル
ホナート、2-シクロヘキシル-2-オキソエチル ジ
イソプロピルスルホニウム トリフルオロメタンスルホ
ナート、2-シクロペンチル-2-オキソエチル ジイ
ソプロピルスルホニウム トリフルオロメタンスルホナ
ート、tert-ブチル メチル (2-オキシプロピ
ル) スルホニウム トリフルオロメタンスルホナート、
tert-ブチル メチル (2-オキシブチル) スルホ
ニウム トリフルオロメタンスルホナート、tert-
ブチル メチル (2-オキシペンチル) スルホニウム
トリフルオロメタンスルホナート、tert-ブチル
メチル (2-オキシヘキシル) スルホニウム トリフル
オロメタンスルホナート、tert-ブチル メチル
(2-オキシヘブチル) スルホニウム トリフルオロメ
タンスルホナート、tert-ブチル メチル (2-オ
キシオクチル) スルホニウム トリフルオロメタンスル
ホナート、tert-ブチル メチル (3-メチル-2
-オキシブチル) スルホニウム トリフルオロメタンス
ルホナート、tert-ブチル (3,3-ジメチル-2
-オキシブチル) メチル スルホニウム トリフルオ
ロメタンスルホナート、tert-ブチル (2-シク
ロヘキシル-2-オキソエチル) メチルスルホニウム
トリフルオロメタンスルホナート、tert-ブチル
(2-シクロペンチル-2-オキソエチル) メチル
スルホニウム トリフルオロメタンスルホナート、

【0026】シクロヘキシル メチル (2-オキシプロ
ピル) スルホニウム トリフルオロメタンスルホナ
ート、シクロヘキシル メチル (2-オキシブチル) スル
ホニウム トリフルオロメタンスルホナート、シクロヘ
キシル メチル (2-オキシペンチル) スルホニウム
トリフルオロメタンスルホナート、シクロヘキシル メ
チル (2-オキシヘキシル) スルホニウム トリフルオ
ロメタンスルホナート、シクロヘキシル メチル (2-
オキシヘブチル) スルホニウム トリフルオロメタンス
ルホナート、シクロヘキシル メチル (2-オキシオク
チル) スルホニウム トリフルオロメタンスルホナ
ート、シクロヘキシル メチル (3-メチル-2-オキシ
ブチル) スルホニウム トリフルオロメタンスルホナ
ート、シクロヘキシル (3,3-ジメチル-2-オキシブ
チル) メチル スルホニウム トリフルオロメタンス
ルホナート、シクロヘキシル (2-シクロヘキシル-
2-オキソエチル) メチルスルホニウム トリフルオ
ロメタンスルホナート、シクロヘキシル (2-シクロ
ペンチル-2-オキソエチル) メチルスルホニウム
トリフルオロメタンスルホナート、

【0027】2-オキシプロピル チアシクロペンタニ
ウム トリフルオロメタンスルホナート、2-オキシブ
チル チアシクロペンタニウム トリフルオロメタンス
ルホナート、2-オキシペンチル チアシクロペンタニ
ウム トリフルオロメタンスルホナート、2-オキシヘ
キシル チアシクロペンタニウム トリフルオロメタン
スルホナート、2-オキシヘブチル チアシクロペンタ
ニウム トリフルオロメタンスルホナート、2-オキシ
オクチル チアシクロペンタニウム トリフルオロメタ
ンスルホナート、3-メチル-2-オキシブチル チア
シクロペンタニウム トリフルオロメタンスルホナ
ート、3,3-ジメチル-2-オキシブチル チアシクロ
ペンタニウム トリフルオロメタンスルホナート、

【0028】2-シクロヘキシル-2-オキソエチル
チアシクロペンタニウム トリフルオロメタンスルホナ
ート、2-シクロペンチル-2-オキソエチル チアシ
クロペンタニウム トリフルオロメタンスルホナート、
2-オキシプロピル チアシクロヘキサニウム トリフ
ルオロメタンスルホナート、2-オキシブチル チアシ
クロヘキサニウム トリフルオロメタンスルホナート、
2-オキシペンチル チアシクロヘキサニウム トリフ
ルオロメタンスルホナート、2-オキシヘキシル チア
シクロヘキサニウム トリフルオロメタンスルホナ
ート、2-オキシヘブチル チアシクロヘキサニウム ト
リフルオロメタンスルホナート、2-オキシオクチル
チアシクロヘキサニウム トリフルオロメタンスルホナ
ート、3-メチル-2-オキシブチル チアシクロヘキ
サニウム トリフルオロメタンスルホナート、3,3-
ジメチル-2-オキシブチル チアシクロヘキサニウム
トリフルオロメタンスルホナート、

【0029】2-シクロヘキシル-2-オキソエチル
チアシクロヘキサニウム トリフルオロメタンスルホナ
ート、2-シクロペンチル-2-オキソエチル チアシ
クロヘキサニウム トリフルオロメタンスルホナート、
2-オキソプロピル (1, 4-チオキサニウム) ト
リフルオロメタンスルホナート、2-オキソブチル

(1, 4-チオキサニウム) トリフルオロメタンスル
ホナート、2-オキソペンチル (1, 4-チオキサニ
ウム) トリフルオロメタンスルホナート、2-オキソ
ヘキシル (1, 4-チオキサニウム) トリフルオロ
メタンスルホナート、2-オキソヘプチル (1, 4-
チオキサニウム) トリフルオロメタンスルホナート、
2-オキソオクチル (1, 4-チオキサニウム) ト
リフルオロメタンスルホナート、3-メチル-2-オキ
ソブチル (1, 4-チオキサニウム) トリフルオロ
メタンスルホナート、3, 3-ジメチル-2-オキソブ
チル (1, 4-チオキサニウム) トリフルオロメタ
ンスルホナート、

【0030】2-シクロヘキシル-2-オキソエチル
(1, 4-チオキサニウム) トリフルオロメタンスル
ホナート、2-シクロペンチル-2-オキソエチル
(1, 4-チオキサニウム) トリフルオロメタンスル
ホナート、2-オキソプロピル (4-オキソチアシク
ロヘキサニウム) トリフルオロメタンスルホナート、
2-オキソブチル (4-オキソチアシクロヘキサニウ
ム) トリフルオロメタンスルホナート、2-オキソペ
ンチル (4-オキソチアシクロヘキサニウム) トリ
フルオロメタンスルホナート、2-オキソヘキシル
(4-オキソチアシクロヘキサニウム) トリフルオロ
メタンスルホナート、2-オキソヘプチル (4-オキ
ソチアシクロヘキサニウム) トリフルオロメタンスル
ホナート、2-オキソオクチル (4-オキソチアシク
ロヘキサニウム) トリフルオロメタンスルホナート、
3-メチル-2-オキソブチル (4-オキソチアシク
ロヘキサニウム) トリフルオロメタンスルホナート、
3, 3-ジメチル-2-オキソブチル (4-オキソチ
アシクロヘキサニウム) トリフルオロメタンスルホナ
ート、

【0031】2-シクロヘキシル-2-オキソエチル
(4-オキソチアシクロヘキサニウム) トリフルオロ
メタンスルホナート、2-シクロペンチル-2-オキソ
エチル (4-オキソチアシクロヘキサニウム) トリ
フルオロメタンスルホナート、2-オキソプロピル
(1, 4-ジチアニウム) トリフルオロメタンスルホ
ナート、2-オキソブチル (1, 4-ジチアニウム)

トリフルオロメタンスルホナート、2-オキソペンチ
ル (1, 4-ジチアニウム) トリフルオロメタンスル
ホナート、2-オキソヘキシル (1, 4-ジチアニウ
ム) トリフルオロメタンスルホナート、2-オキソ
ヘプチル (1, 4-ジチアニウム) トリフルオロメ

タンスルホナート、2-オキソオクチル (1, 4-ジ
チアニウム) トリフルオロメタンスルホナート、3-
メチル-2-オキソブチル (1, 4-ジチアニウム)

トリフルオロメタンスルホナート、3, 3-ジメチル
-2-オキソブチル (1, 4-ジチアニウム) トリ
フルオロメタンスルホナート、

【0032】2-シクロヘキシル-2-オキソエチル
(1, 4-ジチアニウム) トリフルオロメタンスルホ
ナート、2-シクロペンチル-2-オキソエチル
(1, 4-ジチアニウム) トリフルオロメタンスルホ
ナート、2-オキソシクロヘキシル チアシクロペンタ
ニウム トリフルオロメタンスルホナート、ジメチル
(2-オキソプロピル) スルホニウム パーフルオロブ
タンスルホナート、ジメチル (2-オキソブチル) スル
ホニウム パーフルオロブタンスルホナート、ジメチル
(2-オキソペンチル) スルホニウム パーフルオロブ
タンスルホナート、ジメチル (2-オキソヘキシル) ス
ルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、ジメチ
ル (2-オキソヘプチル) スルホニウム パーフルオロ
ブタンスルホナート、ジメチル (2-オキソオクチル)
スルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、ジメ
チル (3-メチル-2-オキソブチル) スルホニウム
パーフルオロブタンスルホナート、3, 3-ジメチル-
2-オキソブチル ジメチルスルホニウム パーフルオ
ロブタンスルホナート、

【0033】2-シクロヘキシル-2-オキソエチル
ジメチルスルホニウム パーフルオロブタンスルホナ
ート、2-シクロペンチル-2-オキソエチル ジメチル
スルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、ジエ
チル (2-オキソプロピル) スルホニウム パーフルオ
ロブタンスルホナート、ジエチル (2-オキソブチル)
スルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、ジエ
チル (2-オキソペンチル) スルホニウム パーフルオ
ロブタンスルホナート、ジエチル (2-オキソヘキシ
ル) スルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、
ジエチル (2-オキソヘプチル) スルホニウム パーフ
ルオロブタンスルホナート、ジエチル (2-オキソオク
チル) スルホニウム パーフルオロブタンスルホナ
ート、ジエチル (3-メチル-2-オキソブチル) スルホ
ニウム パーフルオロブタンスルホナート、3, 3-ジ
メチル-2-オキソブチル ジエチルスルホニウム パ
ーフルオロブタンスルホナート、

【0034】2-シクロヘキシル-2-オキソエチル
ジエチルスルホニウム パーフルオロブタンスルホナ
ート、2-シクロペンチル-2-オキソエチル ジエチル
スルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、ジブ
チル (2-オキソプロピル) スルホニウム パーフルオ
ロブタンスルホナート、ジブチル (2-オキソブチル)
スルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、ジブ
チル (2-オキソペンチル) スルホニウム パーフルオ

【0036】tert-ブチル メチル (2-オキソプロピル) スルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、tert-ブチル メチル (2-オキソブチル) スルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、tert-ブチル メチル (2-オキソペンチル) スルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、tert-ブチル メチル (2-オキソヘキシル) スルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、tert-ブチル メチル (2-オキソヘプチル) スルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、tert-ブチル メチル (2-オキソオクチル) スルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、tert-ブチル メチル (3-メチルー2-オキソブチル) スルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、tert-ブチル (3,3-ジメチルー2-オキソブチル) スルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、tert-ブチル (2-シクロヘキシル-2-オキソエチル) メチルスルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、tert-ブチル (2-シクロヘキシル-2-オキソエチル) メチル

【0039】2-オキソプロピル チアシクロヘキサニウム パーフルオロブタンスルホナート、2-オキソブチル チアシクロヘキサニウム パーフルオロブタンスルホナート、2-オキシペンチル チアシクロヘキサニウム ハーフルオロブタンスルホナート、2-オキソヘキシル チアシクロヘキサニウム、ハーフルオロブタンスルホナート、2-オキソヘプチル チアシクロヘキサニウム、ハーフルオロブタンスルホナート、2-オキソオクタール チアシクロヘキサニウム、ハーフルオロブタンスルホナート、3-メチル-2-オキソブチル チアシクロヘキサニウム、ハーフルオロブタンスルホナート、3,3-ジメチル-2-オキソブチル チアシクロ

【0040】 2-オキソプロピル (1, 4-チオキサニウム) パーフルオロブタンスルホナート、2-オキソブチル (1, 4-チオキサニウム) パーフルオロブタンスルホナート、2-オキソペンチル (1, 4-チオキサニウム) パーフルオロブタンスルホナート、2-オキソヘキシル (1, 4-チオキサニウム) パーフルオロブタンスルホナート、2-オキソヘプチル (1, 4-チオキサニウム) パーフルオロブタンスルホナート、2-オキソオクタチル (1, 4-チオキサニウム) パーフルオロブタンスルホナート、3-メチル-2-オキソブチル (1, 4-チオキサニウム) パーフルオロブタンスルホナート、3,3-ジメチル-2-オキソブチル (1, 4-チオキサニウム) パーフルオロブタンスルホナート、

【0042】 2-シクロヘキシル-2-オキソエチル 40
 (4-オキソチアシクロヘキサニウム) ハーフオル
 プタンスルホネート、2-シクロペンチル-2-オキソ
 エチル (4-オキソチアシクロヘキサニウム) ハー
 フオルオロプタンスルホネート、2-オキソプロピル
 (1,4-ジチアニウム) ハーフオルプタンスルホ
 ネート、2-オキソブチル (1,4-ジチアニウム)

18

パーフルオロブタンスルホナート、3,3-ジメチル-2-オキソブチル (1,4-ジチアニウム) パーフルオロブタンスルホナート、

【 0 0 4 4 】 2-シクロヘキシル-2-オキソエチル ジメチルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホナート、2-シクロペンチル-2-オキソエチル ジメチルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホナート、ジエチル (2-オキソプロピル) スルホニウム パーフルオロオクタンスルホナート、ジエチル (2-オキソブチル) スルホニウム パーフルオロオクタンスルホナート、ジエチル (2-オキソペンチル) スルホニウム パーフルオロオクタンスルホナート、ジエチル (2-オキソヘキシル) スルホニウム パーフルオロオクタンスルホナート、ジエチル (2-オキソヘプチル) スルホニウム パーフルオロオクタンスルホナート、ジエチル (2-オキソオクタチル) スルホニウム パーフルオロオクタンスルホナート、ジエチル (3-メチル-2-オキソブチル) スルホニウム パーフルオロオクタンスルホナート、3,3-ジメチル-2-オキソブチル ジエチルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホナート、

【0045】2-シクロヘキシル-2-オキソエチル
ジエチルスルホニウム、パーフルオロオクタンスルホネート、2-シクロヘキシル-2-オキソエチル-ジエチ
ルスルホニウム、パーフルオロオクタンスルホネート、
ジブチル(2-オキソプロピル)スルホニウム、パーフル
オロオクタンスルホネート、ジブチル(2-オキソプロ
ピル)スルホニウム、パーフルオロオクタンスルホネ

ルホナート、2-オキソブチル (1, 4-ジチアニウム) パーフルオロオクタンスルホナート、2-オキソペンチル (1, 4-ジチアニウム) パーフルオロオクタンスルホナート、2-オキソヘキシル (1, 4-ジチアニウム) パーフルオロオクタンスルホナート、2-オキソヘプチル (1, 4-ジチアニウム) パーフルオロオクタンスルホナート、2-オキソオクチル (1, 4-ジチアニウム) パーフルオロオクタンスルホナート、3-メチル-2-オキソブチル (1, 4-ジチアニウム) パーフルオロオクタンスルホナート、3,3-ジメチル-2-オキソブチル (1, 4-ジチアニウム) パーフルオロオクタンスルホナート。

【0054】2-シクロヘキシル-2-オキソエチル
(1, 4-ジチアニウム) パーフルオロオクタンスル
ホナート、2-シクロペンチル-2-オキソエチル

(1, 4-ジチアニウム) パーフルオロオクタンスルホナート、2-オキソシクロヘキシル チアシクロペンタニウム パーフルオロオクタンスルホナート、ジメチル(2-オキソプロピル)スルホニウム ブタンスルホナート、ジメチル(2-オキソブチル)スルホニウム ブタンスルホナート、ジメチル(2-オキソペンチル)スルホニウム ブタンスルホナート、ジメチル(2-オキソヘキシル)スルホニウム ブタンスルホナート、ジメチル(2-オキソヘプチル)スルホニウム ブタンスルホナート、ジメチル(2-オキソオクチル)スルホニウム ブタンスルホナート、ジメチル(3-メチル-2-オキソブチル)スルホニウム ブタンスルホナート、3, 3-ジメチル-2-オキソブチル ジメチルスルホニウム ブタンスルホナート。

【0055】 2-シクロヘキシル-2-オキソエチル ジメチルスルホニウム ブタンスルホナート、2-シクロペンチル-2-オキソエチル ジメチルスルホニウム ブタンスルホナート、ジエチル (2-オキソプロピル) スルホニウム ブタンスルホナート、ジエチル (2-オキソブチル) スルホニウム ブタンスルホナート、ジエチル (2-オキソペンチル) スルホニウム ブタンスルホナート、ジエチル (2-オキソヘキシル) スルホニウム ブタンスルホナート、ジエチル (2-オキソヘプチル) スルホニウム ブタンスルホナート、ジエチル (2-オキソオクチル) スルホニウム ブタンスルホナート、ジエチル (3-メチル-2-オキソブチル) スルホニウム ブタンスルホナート、3,3-ジメチル-2-オキソブチル ジエチル スルホニウム ブタンスルホナート

【0056】 2-シクロヘキシル-2-オキソエチル ジエチルスルホニウム、ブタンスルホナート、2-シクロペンチル-2-オキソエチル ジエチルスルホニウム、ブタンスルホナート、ジブチル(2-オキソプロピル)スルホニウム、ブタンスルホナート、ジブチル(2-オキソブチル)スルホニウム、ブタンスルホナート。

パーフルオロオクタンスルホナート、2-オキソヘキシル (4-オキソチアシクロヘキサニウム) パーフルオロオクタンスルホナート、2-オキソヘプチル (4-オキソチアシクロヘキサニウム) パーフルオロオクタンスルホナート、2-オキソオクチル (4-オキソチアシクロヘキサニウム) パーフルオロオクタンスルホナート、3-メチル-2-オキソブチル (4-オキソチアシクロヘキサニウム) パーフルオロオクタンスルホナート、3,3-ジメチル-2-オキソブチル (4-オキソチアシクロヘキサニウム) パーフルオロオクタンスルホナート、

【0053】2-シクロヘキシル-2-オキソエチル
(1-オキソチアジクロヘキセン-2-イル) ハーゾルオロ
オクタン-8-イルオート、2-シクロペンチル-2-オキ
ソエチル (1-オキソチアジクロペンセン-2-イル) ハ
ーゾルオロオクタン-8-イルオート、2-オキソプロピル
(1,4-ジチア-2-イル) ハーゾルオロオクタン-8-

ジブチル (2-オキソペンチル) スルホニウム ブタン
スルホナート、ジブチル (2-オキソヘキシル) スルホ
ニウム ブタンスルホナート、ジブチル (2-オキソヘ
プチル) スルホニウム ブタンスルホナート、ジブチル
(2-オキソオクチル) スルホニウム ブタンスルホナ
ート、ジブチル (3-メチル-2-オキソブチル) スル
ホニウム ブタンスルホナート、ジブチル (3,3-ジ
メチル-2-オキソブチル) スルホニウム ブタンスルホ
ナート、ジブチル (2-シクロヘキシル-2-オキソエ
チル) スルホニウム ブタンスルホナート、ジブチル 10
(2-シクロペンチル-2-オキソエチル) スルホニ
ウム ブタンスルホナート、ジイソプロピル (2-オキ
ソプロピル) スルホニウム ブタンスルホナート、ジイ
ソプロピル (2-オキソブチル) スルホニウム ブタン
スルホナート、ジイソプロピル (2-オキソペンチル)
スルホニウム ブタンスルホナート、ジイソプロピル
(2-オキソヘキシル) スルホニウム ブタンスルホナ
ート、ジイソプロピル (2-オキソヘプチル) スルホニ
ウム ブタンスルホナート、ジイソプロピル (2-オキ
ソオクチル) スルホニウム ブタンスルホナート、ジイ 20
ソプロピル (3-メチル-2-オキソブチル) スルホニ
ウム ブタンスルホナート、3,3-ジメチル-2-オキ
ソブチル ジイソプロピル スルホニウム ブタンスル
ホナート、

【0057】 2-シクロヘキシル-2-オキソエチル
ジイソプロピルスルホニウム ブタンスルホナート、2
-シクロペンチル-2-オキソエチル ジイソプロピル
スルホニウム ブタンスルホナート、tert-ブチル
メチル (2-オキソプロピル) スルホニウム ブタン
スルホナート、tert-ブチル メチル (2-オキソ 30
ブチル) スルホニウム ブタンスルホナート、tert
-ブチル メチル (2-オキソペンチル) スルホニウム
ブタンスルホナート、tert-ブチル メチル (2
-オキソヘキシル) スルホニウム ブタンスルホナ
ート、tert-ブチル メチル (2-オキソヘプチル)
スルホニウム ブタンスルホナート、tert-ブチル
メチル (2-オキソオクチル) スルホニウム ブタン
スルホナート、tert-ブチル メチル (3-メチル
-2-オキソブチル) スルホニウム ブタンスルホナ
ート、tert-ブチル (3,3-ジメチル-2-オキソ 40
ブチル) メチル スルホニウム ブタンスルホナ
ート、tert-ブチル (2-シクロヘキシル-2-オ
キソエチル) メチル スルホニウム ブタンスルホナ
ート、tert-ブチル (2-シクロペンチル-2-オ
キソエチル) メチル スルホニウム ブタンスルホナ
ート、

【0058】 シクロヘキシル-メチル (2-オキソプロ
ピル) スルホニウム ブタンスルホナート、シクロヘキ
シル-メチル (2-オキソブチル) スルホニウム ブタ
ンスルホナート、シクロヘキシル-メチル (2-オキソ 50

ペンチル) スルホニウム ブタンスルホナート、シクロ
ヘキシル-メチル (2-オキソヘキシル) スルホニウム
ブタンスルホナート、シクロヘキシル-メチル (2-
オキソヘプチル) スルホニウム ブタンスルホナート、
シクロヘキシル-メチル (2-オキソオクチル) スルホ
ニウム ブタンスルホナート、シクロヘキシル-メチル
(3-メチル-2-オキソブチル) スルホニウム ブタ
ンスルホナート、シクロヘキシル (3,3-ジメチル
2-オキソブチル) メチル スルホニウム ブタンス
ルホナート、シクロヘキシル (2-シクロヘキシル-
2-オキソエチル) メチル スルホニウム ブタンスル
ホナート、シクロヘキシル (2-シクロペンチル-2
-オキソエチル) メチル スルホニウム ブタンスルホ
ナート、2-オキソプロピル チアシクロペンタニウム
ブタンスルホナート、2-オキソブチル チアシクロ
ペンタニウム ブタンスルホナート、2-オキソペンチ
ル チアシクロペンタニウム ブタンスルホナート、2
-オキソヘキシル チアシクロペンタニウム ブタン
スルホナート、2-オキソヘプチル チアシクロペンタニ
ウム ブタンスルホナート、2-オキソオクチル チア 20
シクロペンタニウム ブタンスルホナート、3-メチル
-2-オキソブチル チアシクロペンタニウム ブタン
スルホナート、3,3-ジメチル-2-オキソブチル
チアシクロペンタニウム ブタンスルホナート、

【0059】 2-シクロヘキシル-2-オキソエチル
チアシクロペンタニウム ブタンスルホナート、2-シ
クロペンチル-2-オキソエチル チアシクロペンタニ
ウム ブタンスルホナート、2-オキソプロピル チア
シクロヘキサニウム ブタンスルホナート、2-オキソ
ブチル チアシクロヘキサニウム ブタンスルホナ
ート、2-オキソペンチル チアシクロヘキサニウム
ブタンスルホナート、2-オキソヘキシル チアシクロヘ
キサニウム ブタンスルホナート、2-オキソヘプチル
チアシクロヘキサニウム ブタンスルホナート、2-
オキソオクチル チアシクロヘキサニウム ブタン
スルホナート、3-メチル-2-オキソブチル チアシクロ
ヘキサニウム ブタンスルホナート、3,3-ジメチル
-2-オキソブチル チアシクロヘキサニウム ブタン
スルホナート、

【0060】 2-シクロヘキシル-2-オキソエチル
チアシクロヘキサニウム ブタンスルホナート、2-シ
クロペンチル-2-オキソエチル チアシクロヘキサニ
ウム ブタンスルホナート、2-オキソプロピル
(1,4-チオキサニウム) ブタンスルホナート、2-
オキソブチル (1,4-チオキサニウム) ブタン
スルホナート、2-オキソペンチル (1,4-チオキ 30
サニウム) ブタンスルホナート、2-オキソヘキシル
(1,4-チオキサニウム) ブタンスルホナート、
2-オキソヘプチル (1,4-チオキサニウム) ブ
タンスルホナート、2-オキソオクチル (1,4-チ

オキサニウム) ブタンスルホナート、3-メチル-2-オキソブチル (1, 4-チオキサニウム) ブタン

スルホナート、3, 3-ジメチル-2-オキソブチル

(1, 4-チオキサニウム) ブタンスルホナート、

【0061】 2-シクロヘキシル-2-オキソエチル

(1, 4-チオキサニウム) ブタンスルホナート、2-

シクロペンチル-2-オキソエチル (1, 4-チオ

キサニウム) ブタンスルホナート、2-オキソプロピル

(4-オキソチアシクロヘキサニウム) ブタン

スルホナート、2-オキソブチル (4-オキソチアシク

ロヘキサニウム) ブタンスルホナート、2-オキソペ

ンチル (4-オキソチアシクロヘキサニウム) ブタ

ンスルホナート、2-オキソヘキシル (4-オキソチ

アシクロヘキサニウム) ブタンスルホナート、2-オ

キソヘブチル (4-オキソチアシクロヘキサニウム)

ブタンスルホナート、2-オキソオクチル (4-オ

キソチアシクロヘキサニウム) ブタンスルホナート、

3-メチル-2-オキソブチル (4-オキソチアシク

ロヘキサニウム) ブタンスルホナート、3, 3-ジメ

チル-2-オキソブチル (4-オキソチアシクロヘキ

サニウム) ブタンスルホナート、

【0062】 2-シクロヘキシル-2-オキソエチル

(4-オキソチアシクロヘキサニウム) ブタンスルホ

ナート、2-シクロペンチル-2-オキソエチル (4-

オキソチアシクロヘキサニウム) ブタンスルホナ

ート、2-オキソプロピル (1, 4-ジチアニウム)

ブタンスルホナート、2-オキソブチル (1, 4-ジ

チアニウム) ブタンスルホナート、2-オキソペンチ

ル (1, 4-ジチアニウム) ブタンスルホナート、

2-オキソヘキシル (1, 4-ジチアニウム) ブタ

ンスルホナート、2-オキソヘブチル (1, 4-ジチ

アニウム) ブタンスルホナート、2-オキソオクチル

(1, 4-ジチアニウム) ブタンスルホナート、3-

メチル-2-オキソブチル (1, 4-ジチアニウ

ム) ブタンスルホナート、3, 3-ジメチル-2-オ

キソブチル (1, 4-ジチアニウム) ブタンスルホ

ナート、

【0063】 2-シクロヘキシル-2-オキソエチル

(1, 4-ジチアニウム) ブタンスルホナート、2-

シクロペンチル-2-オキソエチル (1, 4-ジチア

ニウム) ブタンスルホナート、2-オキソシクロヘキ

シル-チアシクロペンタニウム) ブタンスルホナート、

ジメチル (2-オキソプロピル) スルホニウム、p-

ートルエンスルホナート、ジメチル (2-オキソブチル) ス

ルホニウム、p-ートルエンスルホナート、ジメチル (2-

オキソペンチル) スルホニウム、p-ートルエンスルホ

ナート、ジメチル (2-オキソヘキシル) スルホニウム

p-ートルエンスルホナート、ジメチル (2-オキソヘ

ブチル) スルホニウム、p-ートルエンスルホナート、ジ

メチル (2-オキソオクチル) スルホニウム、p-ートル

10

20

30

40

50

エンスルホナート、ジメチル (3-メチル-2-オキシ

ブチル) スルホニウム p-ートルエンスルホナート、

3, 3-ジメチル-2-オキシブチル ジメチルスルホ

ニウム p-ートルエンスルホナート、

【0064】 2-シクロヘキシル-2-オキソエチル

ジメチルスルホニウム p-ートルエンスルホナート、2-

シクロペンチル-2-オキソエチル ジメチルスルホ

ニウム p-ートルエンスルホナート、ジエチル (2-オ

キソプロピル) スルホニウム p-ートルエンスルホナ

ート、ジエチル (2-オキシブチル) スルホニウム p-

ートルエンスルホナート、ジエチル (2-オキソペンチ

ル) スルホニウム p-ートルエンスルホナート、ジエチ

ル (2-オキソヘキシル) スルホニウム p-ートルエン

スルホナート、ジエチル (2-オキソヘブチル) スルホ

ニウム p-ートルエンスルホナート、ジエチル (2-オ

キソオクチル) スルホニウム p-ートルエンスルホナ

ート、ジエチル (3-メチル-2-オキシブチル) スルホ

ニウム p-ートルエンスルホナート、3, 3-ジメチル

-2-オキシブチル ジエチルスルホニウム p-ートル

エンスルホナート、

【0065】 2-シクロヘキシル-2-オキソエチル

ジエチルスルホニウム p-ートルエンスルホナート、2-

シクロペンチル-2-オキソエチル ジエチルスルホ

ニウム p-ートルエンスルホナート、ジブチル (2-オ

キシプロピル) スルホニウム p-ートルエンスルホナ

ート、ジブチル (2-オキシブチル) スルホニウム p-

ートルエンスルホナート、ジブチル (2-オキソペンチ

ル) スルホニウム p-ートルエンスルホナート、ジブチ

ル (2-オキソヘキシル) スルホニウム p-ートルエン

スルホナート、ジブチル (2-オキソヘブチル) スルホ

ニウム p-ートルエンスルホナート、ジブチル (2-オ

キシオクチル) スルホニウム p-ートルエンスルホナ

ート、ジブチル (3-メチル-2-オキシブチル) スルホ

ニウム p-ートルエンスルホナート、ジブチル (3, 3-

-ジメチル-2-オキシブチル) スルホニウム p-ートル

エンスルホナート、ジブチル (2-シクロヘキシル-2-

オキソエチル) スルホニウム p-ートルエンスルホ

ナート、ジブチル (2-シクロペンチル-2-オキソエ

チル) スルホニウム p-ートルエンスルホナート、ジ

イソプロピル (2-オキシプロピル) スルホニウム p-

ートルエンスルホナート、ジイソプロピル (2-オキシ

ブチル) スルホニウム p-ートルエンスルホナート、ジ

イソプロピル (2-オキソペンチル) スルホニウム、p-

ートルエンスルホナート、ジイソプロピル (2-オキシ

ヘキシル) スルホニウム p-ートルエンスルホナート、

ジイソプロピル (2-オキソヘブチル) スルホニウム、

p-ートルエンスルホナート、ジイソプロピル (2-オキ

ソオクチル) スルホニウム p-ートルエンスルホナ

ート、ジイソプロピル (3-メチル-2-オキシブチル)

スルホニウム p-ートルエンスルホナート、3, 3-ジ

【0068】2-オキソプロピル-チアシクロペンタニウム、p-トルエンスルホナート、2-オキソブチル-チアシクロペンタニウム、p-トルエンスルホナート、2-オキソペンチル-チアシクロペンタニウム、p-トルエンスルホナート、2-オキソヘキシル-チアシクロペンタニウム、p-トルエンスルホナート、2-オキソ

【0070】 2-シクロヘキシル-2-オキソエチル
(1, 4-チオキサニウム) p-トルエンスルホナート、2-シクロペンチル-2-オキソエチル (1, 4-チオキサニウム) p-トルエンスルホナート、2-オキソプロピル (4-オキソチアシクロヘキセニウム) p-トルエンスルホナート、2-オキソブチル (4-オキソチアシクロヘキセニウム) p-トルエンスルホナート、2-オキソペンチル (4-オキソチアシクロヘキセニウム) p-トルエンスルホナート、2-オキソヘキシル (4-オキソチアシクロヘキセニウム) p-トルエンスルホナート、2-オキソヘプチル

(4-オキソチアシクロヘキサニウム) p-トルエン
スルホナート、2-オキソオクチル (4-オキソチ
アシクロヘキサニウム) p-トルエン
スルホナート、3-メチル-2-オキソブチル (4-オキソチアシ
クロヘキサニウム) p-トルエン
スルホナート、3,3-ジメチル-2-オキソブチル (4-オキソチアシ
クロヘキサニウム) p-トルエン
スルホナート、

【0071】2-シクロヘキシル-2-オキソエチル
(4-オキソチアシクロヘキサニウム) p-トルエン
スルホナート、2-シクロペンチル-2-オキソエチル

(4-オキソチアシクロヘキサニウム) p-トルエン
スルホナート、2-オキソプロピル (1,4-ジチ
アニウム) p-トルエン
スルホナート、2-オキソブ
チル (1,4-ジチアニウム) p-トルエン
スルホナート、2-オキソペンチル (1,4-ジチアニ
ウム) p-トルエン
スルホナート、2-オキソヘキシル

(1,4-ジチアニウム) p-トルエン
スルホナート、2-オキソヘブチル (1,4-ジチアニ
ウム) p-トルエン
スルホナート、2-オキソオクチル

(1,4-ジチアニウム) p-トルエン
スルホナート、3-メチル-2-オキソブチル (1,4-ジチ
アニウム) p-トルエン
スルホナート、3,3-ジメチ
ル-2-オキソブチル (1,4-ジチアニウム) p-
トルエン
スルホナート、2-シクロヘキシル-2-オ
キソエチル (1,4-ジチアニウム) p-トルエン
スルホナート、2-シクロペンチル-2-オキソエチル

(1,4-ジチアニウム) p-トルエン
スルホナート、2-オキソシクロヘキシル チアシクロペンタニウ
ム p-トルエン
スルホナート、

【0072】ジメチル (2-オキソプロピル) スルホニ
ウム カンファースルホナート、ジメチル (2-オキシ
ブチル) スルホニウム カンファースルホナート、ジメ
チル (2-オキソペンチル) スルホニウム カンファ
ースルホナート、ジメチル (2-オキソヘキシル) スルホ
ニウム カンファースルホナート、ジメチル (2-オキ
ソヘブチル) スルホニウム カンファースルホナート、
ジメチル (2-オキソオクチル) スルホニウム カン
ファースルホナート、ジメチル (3-メチル-2-オキシ
ブチル) スルホニウム カンファースルホナート、3,
3-ジメチル-2-オキソブチル ジメチルスルホニウ
ム カンファースルホナート、2-シクロヘキシル-2-
オキソエチル ジメチルスルホニウム カンファ
ースルホナート、2-シクロペンチル-2-オキソエチル
ジメチルスルホニウム カンファースルホナート、ジ
エチル (2-オキソブチル) スルホニウム カンファ
ースルホナート、ジエチル (2-オキソペンチル) スル
ホニウム カンファースルホナート、ジエチル (2-オ
キソヘキシル) スルホニウム カンファ
ースルホナート、ジエチル (2-オキソヘブチル) スル

ホニウム カンファースルホナート、ジエチル (2-オ
キシオクチル) スルホニウム カンファースルホナ
ート、ジエチル (3-メチル-2-オキソブチル) スルホ
ニウム カンファースルホナート、

【0073】3,3-ジメチル-2-オキソブチル ジ
エチルスルホニウム カンファースルホナート、2-シ
クロヘキシル-2-オキソエチル ジエチルスルホニウ
ム カンファースルホナート、2-シクロペンチル-2-
オキソエチル ジエチルスルホニウム カンファ
ースルホナート、ジブチル (2-オキソプロピル) スルホ
ニウム カンファースルホナート、ジブチル (2-オキシ
ブチル) スルホニウム カンファースルホナート、ジブ
チル (2-オキソペンチル) スルホニウム カンファ
ースルホナート、ジブチル (2-オキソヘキシル) スルホ
ニウム カンファースルホナート、ジブチル (2-オキ
ソヘブチル) スルホニウム カンファースルホナート、
ジブチル (2-オキソオクチル) スルホニウム カン
ファースルホナート、ジブチル (3-メチル-2-オキシ
ブチル) スルホニウム カンファースルホナート、ジブ
チル (3,3-ジメチル-2-オキソブチル) スルホニウ
ム カンファースルホナート、ジブチル (2-シクロヘ
キシル-2-オキソエチル) スルホニウム カンファ
ースルホナート、ジブチル (2-シクロペンチル-2-
オキソエチル) スルホニウム カンファースルホナ
ート、

【0074】ジイソプロピル (2-オキソプロピル) ス
ルホニウム カンファースルホナート、ジイソプロピル
(2-オキソブチル) スルホニウム カンファースルホ
ナート、ジイソプロピル (2-オキソペンチル) スルホ
ニウム カンファースルホナート、ジイソプロピル (2-
オキソヘキシル) スルホニウム カンファースルホナ
ート、ジイソプロピル (2-オキソヘブチル) スルホ
ニウム カンファースルホナート、ジイソプロピル (2-
オキソオクチル) スルホニウム カンファースルホナ
ート、ジイソプロピル (3-メチル-2-オキソブチル)
スルホニウム カンファースルホナート、3,3-ジメ
チル-2-オキソブチル ジイソプロピル スルホニウム
 カンファースルホナート、2-シクロヘキシル-2-
オキソエチル ジイソプロピルスルホニウム カンファ
ースルホナート、2-シクロペンチル-2-オキソエチ
ル ジイソプロピルスルホニウム カンファースルホナ
ート、

【0075】tert-ブチル-メチル (2-オキソプロ
ピル) スルホニウム カンファースルホナート、tert-
ブチル-メチル (2-オキソブチル) スルホニウ
ム カンファースルホナート、tert-ブチル-メチ
ル (2-オキソペンチル) スルホニウム カンファ
ースルホナート、tert-ブチル-メチル (2-オキソヘ
キシル) スルホニウム カンファースルホナート、tert-
ブチル-メチル (2-オキソヘブチル) スルホニ

10

20

30

40

50

【0077】2-シクロヘキシル-2-オキソエチル
チアシクロペンタニウム カンファースルホサート、2-
シクロペンチル-2-オキソエチル チアシクロペン
タニウム、カンファースルホサート、2-オキソプロピ
ル チアシクロヘキセニウム カンファースルホサー
ト、2-オキソブチル チアシクロヘキセニウム、カン
ファースルホサート、2-オキソペンチル チアシクロ
ヘキセニウム、カンファースルホサート、2-オキソヘ
キシル チアシクロヘキセニウム、カンファースルホサ
ート、2-オキソヘプチル チアシクロヘキセニウム、

10

20

30

-40

200

32

【0080】 2-シクロヘキシル-2-オキソエチル
(4-オキソチアシクロヘキサニウム) カンファース
ルホサート、2-シクロペンチル-2-オキソエチル
(4-オキソチアシクロペンタニウム) カンファース
ルホサート、2-オキソプロピル (1, 4-ジチアニ
ウム、カンファースルホサート、2-オキソブチル
(1, 4-ジチアニウム) カンファースルホサート、
2-オキソペンチル (1, 4-ジチアニウム) カン
ファースルホサート、2-オキソヘキシル (1, 4-
ジチアニウム) カンファースルホサート、2-オキソ

(IIa) 及び (IIb) において、 P^1 、 P^2 、 P^3 、 P^4 及び P^5 はそれぞれ、互いに独立に水素、水酸基、炭素数 1 ～ 6 のアルキル基又は炭素数 1 ～ 6 のアルコキシ基を表し、アルキル基及びアルコキシ基は、炭素数 3 以上の場合は直鎖でも分岐していてもよい。具体的なアルキル基の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基などが挙げられ、アルコキシ基の例としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基などが挙げられる。また式 (IIa) 及び (IIb) において、陰イオンを構成する $P^6SO_3^-$ 、 $P^7SO_3^-$ は、有機スルホナートイオンを表す。ここで、 P^6 、 P^7 は、それぞれ独立に、炭素数 1 ～ 12 程度の有機基であれば良く、例えば炭素数 1 ～ 8 のパーフルオロアルキル基、炭素数 1 ～ 8 のアルキル基、炭素数 6 ～ 12 の芳香族基、ウンフラー基であることができる。炭素数 1 ～ 8 のパーフルオロアルキル基、炭素数 1 ～ 8 のアルキル基、炭素数 6 ～ 12 の芳香族基等の具体例としては、前記した

[illegible]

p-トルエンスルホナート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム カンファースルホナート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホナート、4-ヒドロキシフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、トリス（4-メチルフェニル）スルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、トリス（4-メトキシフェニル）スルホニウム パーフルオロブタンスルホナート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホナート、4-ヒドロキシフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホナート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホナート、トリス（4-メチルフェニル）スルホニウム パーフルオロオクタンスルホナート、トリス（4-メトキシフェニル）スルホニウム パーフルオロオクタンスルホナート。

【 0 0 8 7 】 ジフェニルヨードニウム パーフルオロブ
 タンスルホナート、ジ（４－メトキシフェニル）ヨード
 ニウム パーフルオロオクタンスルホナート、ジ（４－
 tert－ブチルフェニル）ヨードニウム パーフルオロオ
 クタンスルホナート、ジ（４－tert－ブチルフェニル）
 ヨードニウム メタンスルホナート、ジ（４－tert－ブ
 チルフェニル）ヨードニウム エタンスルホナート、ジ
 （４－tert－ブチルフェニル）ヨードニウム プタンス
 ルホナート、ジ（４－tert－ブチルフェニル）ヨードニ
 ウム ベンゼンスルホナート、ジ（４－tert－ブチルフ
 ェニル）ヨードニウム p－トルエンシルホナート、ジ
 （４－tert－ブチルフェニル）ヨードニウム カンファ
 ールシルホナート、など。

【0088】次に、本発明のレジスト組成物を構成する樹脂成分について説明する。この樹脂は、酸に不安定な基を持つ重合単位を有する、化学増幅型ポジ型レジスト用の樹脂は、それ自体ではアルカリに不溶又は難溶であるが、酸の作用により一部の基が解裂し、解裂後はアルカリ可溶性となるものである。本発明における酸に不安定な基も、このように従来から知られている各種のものであることができる。酸に不安定な基として具体的には、カルボン酸の各種エステル、例えば、メチルエステル及びtert-ブチルエステルに代表されるアルキルエステル、メトキシメチルエステル、エトキシメチルエステル、1-エトキシエチルエステル、1-イソブトキシエチルエステル、1-イソプロポキシエチルエステル、1-

エトキシシタリヒエトキシアル、1 - (2 - エトキシエトキシ) エチルエスアル、1 - (2 - アセトキシエトキシ) エチルエスアル、1 - 2 - (1 - アダマンチルオキシ) エトキシ エチルエスアル、1 - 2 - (1 - アダマンタンカルボキシエトキシ) エトキシ エチルエスアル

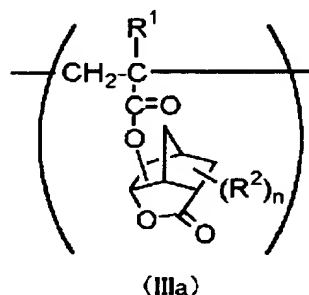
【0089】このようなモノマーのうち、酸の作用により解裂する基として例えば2-アルキル-2-アダマンチル、1-(1-アダマンチル)-1-アルキルアルキルのような脂環族を含む嵩高い基を有するものを使用すると解像度が優れるので好ましい。このような嵩高い基を含むモノマーとしては、(メタ)アクリル酸2-アルキル-2-アダマンチル、(メタ)アクリル酸1-(1-アダマンチル)-1-アルキルアルキル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸2-アルキル-2-アダマンチル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸1-(1-アダマンチル)-1-アルキルアルキルなどが挙げられる。とりわけ(メタ)アクリル酸2-アルキル-2-アダマンチルをモノマーとして用いた場合は、解像度が優れるので好ましい。このような(メタ)アクリル酸2-アルキル-2-アダマンチルの代表例としては、例えばアクリル酸2-メチル-2-アダマンチル、メタクリル酸2-メチル-2-アダマンチル、アクリル酸2-エチル-2-アダマンチル、メタクリル酸2-エチル-2-アダマンチル、アクリル酸2-n-ブチル-2-アダマンチルなどが挙げられる。これらの中では、特に(メタ)アクリル酸2-エチル-2-アダマンチルを用いた場合、感度、耐熱性のバランスが良いので好ましい。もちろん必要に応じて、酸の作用により解裂する基を持つ他のモノマーを併用してもよい。

【0090】(メタ)アクリル酸2-アルキル-2-アダマンチルは通常、2-アルキル-2-アダマンタノール又はその金属塩とアクリル酸ハライド又はメタクリル酸ハライドとの反応により製造できる。

【００９１】本発明における樹脂は、上記のような酸に不安定な基を有する重合単位の他に、酸の作用により解裂しないか又は解裂しにくい他の重合単位を含有することも、もちろん可能である。含有しうる他の重合単位としては、例えば、アクリル酸やメタクリル酸のような遊離のカルボン酸基を有するモノマーの重合単位、無水マレイン酸や無水イタコン酸のような脂肪族不飽和ジカルボン酸無水物の重合単位、２－ノルボルネンの重合単位、（メタ）アクリロニトリルの重合単位、各種（メタ）アクリル酸エステル類の重合単位などを挙げるこ

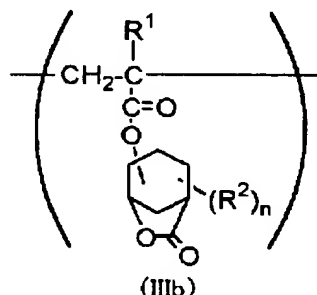
ができる。A r F 露光の場合は光吸収が大きくて好ましくはないが、K r F 露光の場合は光吸収の問題が無いので、ヒドロキ西斯チレンの重合単位を用いることができる。

【0092】特に、p-ヒドロキ西斯チレンの重合単位、m-ヒドロキ西斯チレンの重合単位、(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチルの重合単位、*



* (メタ)アクリル酸3、5-ジヒドロキシ-1-アダマンチルの重合単位、ラクトン環がアルキルで置換されていてもよい(メタ)アクリロイロキシ-γ-ブチロラクトンの重合単位、下式(IIIa)、(IIIb)で示される脂環式ラクトンの重合単位などを共重合させることはレジストの基板への接着性の点で好ましい。

【0093】

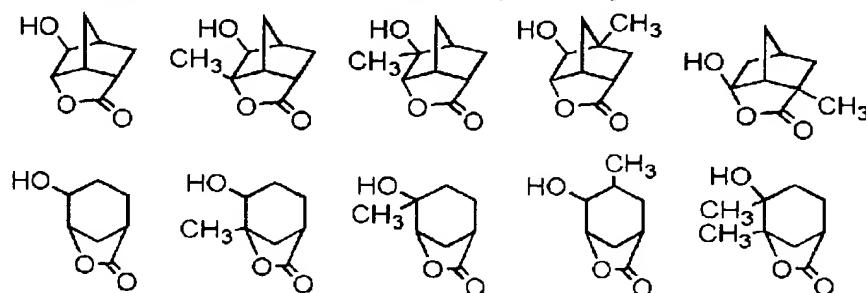


【0094】(式中、R¹、R²は互いに独立に水素、メチル又はトリフルオロメチルを表し、nは1~3の数を表す。)

【0095】(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチル、(メタ)アクリル酸3、5-ジヒドロキシ-1-アダマンチルは市販されているが、例えば対応するヒドロキシアダマンタンを(メタ)アクリル酸又はそのハライドと反応させることにより、製造することもできる。また、(メタ)アクリロイロキシ-γ-ブチロラクトンは、ラクトン環がアルキルで置換されていてもよいα-若しくはβ-プロモ-γ-ブチロラクトンにアクリル酸若しくはメタクリル酸を反応させるか、又はラ※

※クトン環がアルキルで置換されていてもよいα-若しくはβ-ヒドロキシ-γ-ブチロラクトンにアクリル酸ハライド若しくはメタクリル酸ハライドを反応させることにより製造できる。式(IIIa)、(IIIb)で示される脂環式ラクトンの重合単位に導くためのモノマーは、具体的には例えば、次のような水酸基を有する脂環式ラクトンの(メタ)アクリル酸エステル、それらの混合物等が挙げられる。これらのエステルは、例えば対応する水酸基を有する脂環式ラクトンと(メタ)アクリル酸類との反応により製造し得る(例えば特開2000-26446号公報)。

【0096】



【0097】(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチル、(メタ)アクリル酸3、5-ジヒドロキシ-1-アダマンチルの重合単位、α-(メタ)アクリロイロキシ-γ-ブチロラクトンの重合単位、β-(メタ)アクリロイロキシ-γ-ブチロラクトンの重合単位、式(IIIa)、(IIIb)で示される脂環式ラクトンの重合単位は、いずれも極性が高く、それらがいずれかを樹脂中に存在させることにより、それを含むレジストの基板への接着性が向上する。これらの重合単位はまたレジストの解像性の向上にも寄与する。

【0098】ここで、(メタ)アクリロイロキシ-γ-ブチロラクトンの重合単位に導くためのモノマーとしては、例えば、α-アクリロイロキシ-γ-ブチラクト

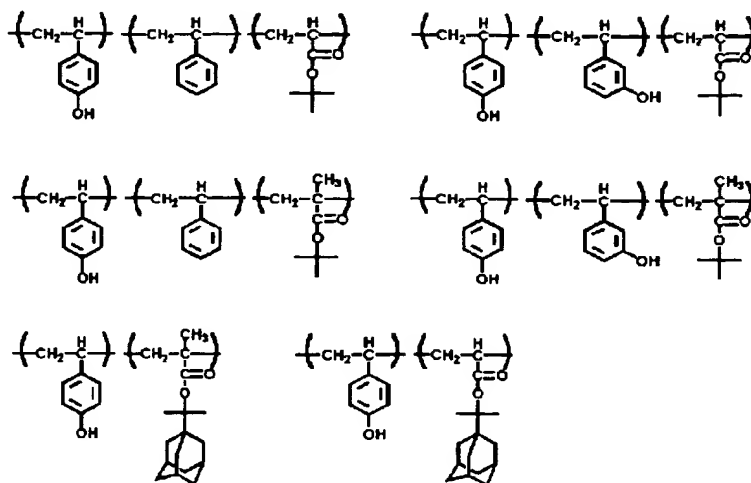
ン、α-メタクリロイロキシ-γ-ブチロラクトン、α-アクリロイロキシ-β、β-ジメチル-γ-ブチロラクトン、α-メタクリロイロキシ-β、β-ジメチル-γ-ブチロラクトン、α-アクリロイロキシ-α-メチル-γ-ブチロラクトン、α-メタクリロイロキシ-α-メチル-γ-ブチロラクトン、β-アクリロイロキシ-γ-ブチロラクトン、β-メタクリロイロキシ-γ-ブチロラクトン、β-メタクリロイロキシ-α-メチル-γ-ブチロラクトンなどが挙げられる。

【0099】K r F エキシマレーザ露光の場合は、樹脂の重合単位として、ヒドロキ西斯チレンの重合単位を用いても充分な透過率を得ることができる。具体的には、以下に示されるようなp-またはm-ヒドロキシス

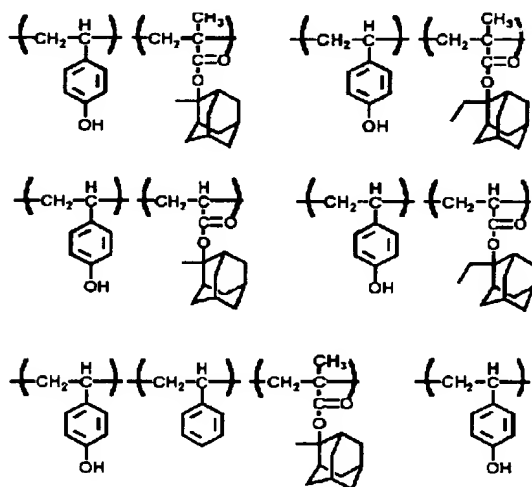
チレン共重合樹脂が挙げられる。このような共重合樹脂を得る場合は、該当する（メタ）アクリル酸エステルモノマーとアセトキシチレン、及びスチレンをラジカル*

*重合した後、酸によって脱アセチルすることによって得ることができる。

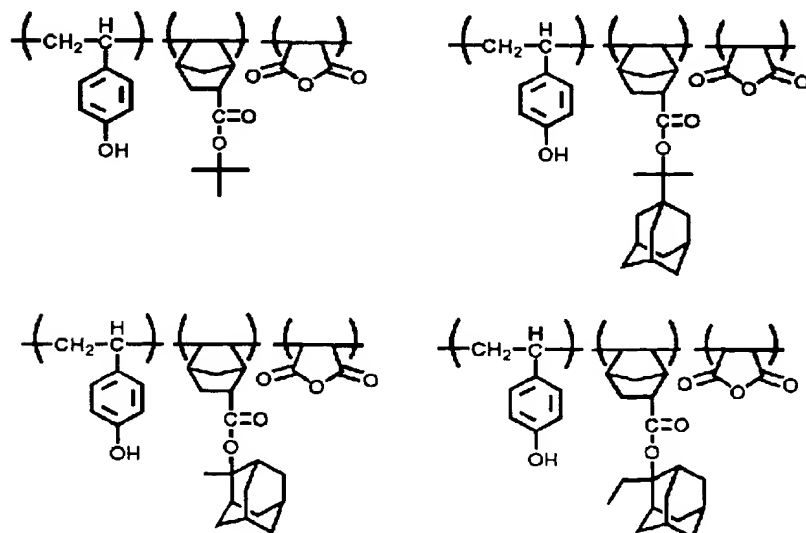
【0100】



【0101】



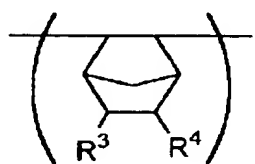
【0102】



【0103】 これらの場合、酸に不安定な基としては、50-2-アクリル-2-アジマンチル、1-(1-アジマン

チル) - 1 - アルキルアルキルを用いるほうが、ドライエッチング耐性の面で有利である。

【0104】また2-ノルボルネンの重合単位を含む樹脂は、その主鎖に直接脂環基を有するために頑丈な構造となり、ドライエッチング耐性に優れるという特性を示す。2-ノルボルネンの重合単位は、例えば対応する2-ノルボルネンの他に無水マレイン酸や無水イタコン酸のような脂肪族不飽和ジカルボン酸無水物を併用したラ*



(IV)

【0106】ここで、式 (IV) 中の R^3 及び R^4 は互いに独立に、水素、炭素数1~3のアルキル、炭素数1~3のヒドロキシアルキル、カルボキシル、シアノ若しくは基- $COOZ$ (Z はアルコール残基である)を表すか、又は R^3 と R^4 が一緒になって、 $-C(=O)OC(=O)-$ で示されるカルボン酸無水物残基を形成することもできる。 R^3 及び/又は R^4 がアルキルである場合の具体例としては、メチル、エチル、プロピルなどが挙げられ、同じくヒドロキシアルキルである場合の具体例としては、ヒドロキシメチル、2-ヒドロキシエチルなどが挙げられる。 R^3 及び/又は R^4 が基- $COOZ$ である場合は、カルボキシルがエステルとなったものであり、 Z に相当するアルコール残基としては、例えば、置換されていてもよい炭素数1~8程度のアルキル、2-オキソオキシラン-3-又は-4-イルなどを挙げることができ、ここにアルキルの置換基としては、水酸基や脂環式炭化水素残基などが挙げられる。そこで、 R^3 及び/又は R^4 が- $COOZ$ で示されるカルボン酸エステル残基である場合の具体例としては、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、2-ヒドロキシエトキシカルボニル、tert-ブトキシカルボニル、2-オキソオキシラン-3-イルオキシカルボニル、2-オキソオキシラン-4-イルオキシカルボニル、1, 1, 2-トリメチルプロポキシカルボニル、1-シクロヘキシル-1-メチルエトキシカルボニル、1-(4-メチルシクロヘキシル)-1-メチルエトキシカルボニル、1-(1-アダマンチル)-1-メチルエトキシカルボニルなどが挙げられる。

【0107】また式 (IV) で示される2-ノルボルネンの重合単位に導くためのモノマーとして、具体的には例えば、次のような化合物を挙げることができる。

【0108】2-ノルボルネン

2-ヒドロキシ-5-ノルボルネン

5-ノルボルネン-2-カルボン酸

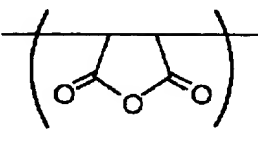
5-ノルボルネン-2-カルボン酸メチル

5-ノルボルネン-2-カルボン酸1-メチル

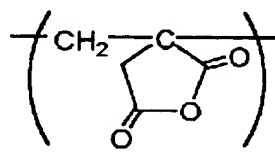
5-ノルボルネン-2-カルボン酸1-シクロヘキシル

*ジカル重合により主鎖へ導入し得る。したがって、2-ノルボルネンの重合単位は、その二重結合が開いて形成されるものであり式 (IV) で表すことができる。また脂肪族不飽和ジカルボン酸無水物の重合単位である無水マレイン酸の重合単位、無水イタコン酸の重合単位は、それらの二重結合が開いて形成されるものであり、それぞれ式 (V) 及び (VI) で表すことができる。

【0105】



(V)



(VI)

-1-メチルエチル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸1-(4-メチルシクロヘキシル)-1-メチルエチル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸1-(4-ヒドロキシシクロヘキシル)-1-メチルエチル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸1-メチル-1-(4-オキソシクロヘキシル)エチル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸1-(1-アダマンチル)-1-メチルエチル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸1-メチルシクロヘキシル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸2-メチル-2-アダマンチル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸2-エチル-2-アダマンチル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸2-ヒドロキシ-1-エチル、5-ノルボルネン-2-メタノール、5-ノルボルネン-2, 3-ジカルボン酸無水物など。

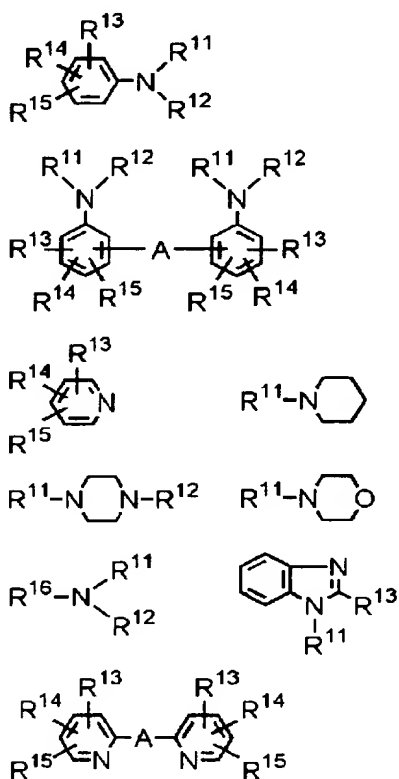
【0109】本発明で用いる樹脂は、パターンニング露光用の放射線の種類や酸に不安定な基の種類などによっても変動するが、一般には、酸に不安定な基を持つ重合単位を10~80モル%の範囲で含有するのが好ましい。そして、酸に不安定な基として特に、(メタ)アクリル酸2-アルキル-2-アダマンチル、(メタ)アクリル酸1-(1-アダマンチル)-1-アルキルアルキルの重合単位を用いる場合は、この単位が樹脂全体のうち1.5モル%以上となるようにするのが有利である。また、酸に不安定な基を持つ重合単位に加えて、酸の作用で解裂しにくい他の重合単位、例えば、(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチルの重合単位、(メタ)アクリル酸3, 5-ジヒドロキシ-1-アダマンチル、 α -(メタ)アクリロイロキシ- γ -ブチラクトンの重合単位、 β -(メタ)アクリロイロキシ- γ -ブチラクトンの重合単位、式 (IIIa)、(IIIb) で示される脂環式ラク톤の重合単位、ヒドロキシシチレンの重合単位、式 (IV) で示される2-ノルボルネンの重合単位、脂肪族不飽和ジカルボン酸無水物の重合単位である式 (V) で示される無水マレイン酸の重合単位、式 (VI) で示される無水イタコン酸の重合単位などを存在させる場合は、それらの合計が、樹脂全体のうち20

～90モル%の範囲となるようにするのが好ましい。

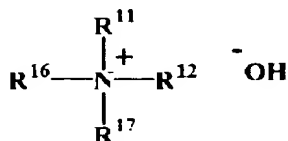
【0110】尚、2-ノルボルネン類及び脂肪族不飽和ジカルボン酸無水物を共重合モノマーとする場合には、これらは重合しにくい傾向があるので、この点を考慮し、これらは過剰に使用することが好ましい。

【0111】また、本発明の化学増幅型のポジ型レジスト組成物においては、塩基性化合物、特に塩基性含窒素有機化合物、例えばアミン類を、クエンチャーとして添加することにより、露光後の引き置きに伴う酸の失活による性能劣化を改良できる。クエンチャーに用いられる塩基性化合物の具体的な例としては、以下の各式で示されるようなものが挙げられる。

【0112】



【0113】



【0114】式中、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{17} は、それぞれ独立に、水素、アルキル、シクロアルキル又はアリールを表す。該アルキル、シクロアルキル又はアリールは、それぞれ独立に、水酸基、アミノ基、又は炭素数1～6のアルコキシ基で置換されていてもよい。該アミノ基は、炭素数1～4のアルキル基で置換されていてもよい。また、該アルキルは、炭素数1～6程度が好ましく、該シクロアルキルは、炭素数5～10程度が好ましく、該アリールは、炭素数6～10程度が好ましい。 R^{16} は、

及び R^{15} は、それぞれ独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、アリール又はアルコキシを表す。該アルキル、シクロアルキル、アリール、又はアルコキシは、それぞれ独立に、水酸基、アミノ基、又は炭素数1～6のアルコキシ基、で置換されていてもよい。該アミノ基は、炭素数1～4のアルキル基で置換されていてもよい。また、該アルキルは、炭素数1～6程度が好ましく、該シクロアルキルは、炭素数5～10程度が好ましく、該アリールは、炭素数6～10程度が好ましく、該アルコキシは、炭素数1～6程度が好ましい。 R^{16} は、アルキル又はシクロアルキルを表す。該アルキル又はシクロアルキルは、それぞれ独立に、水酸基、アミノ基、炭素数1～6のアルコキシ基、で置換されていてもよい。該アミノ基は、炭素数1～4のアルキル基で置換されていてもよい。また、該アルキルは、炭素数1～6程度が好ましく、該シクロアルキルは、炭素数5～10程度が好ましい。Aは、アルキレン、カルボニル、イミノ、スルフィド又はジスルフィドを表す。該アルキレンは、炭素数2～6程度であることが好ましい。また、 $R^{11} \sim R^{17}$ において、直鎖構造と分岐構造の両方を取り得るものについては、そのいずれでもよい。

【0115】本発明のレジスト組成物は、その全固形分量を基準に、樹脂を80～99.9重量%程度、そして酸発生剤を0.1～20重量%程度の範囲で含有するのが好ましい。本発明において、式(I)のスルホニウム塩と、式(IIa)のトリフェニルスルホニウム塩及び式(IIb)のヨードニウム塩から選ばれる少なくとも1種のオニウム塩を酸発生剤として併用する場合、両者は通常、9:1～1:9程度、さらには8:2～2:8程度の重量割合で用いるのが好ましい。また、クエンチャーとしての塩基性化合物を用いる場合は、レジスト組成物の全固形分量を基準に、0.01～1重量%程度の範囲で含有するのが好ましい。この組成物はまた、必要に応じて、増感剤、溶解抑止剤、他の樹脂、界面活性剤、安定剤、染料など、各種の添加物を少量含有することもできる。

【0116】本発明のレジスト組成物は通常、上記の各成分が溶剤に溶解された状態でレジスト液組成物とされ、シリコンウェハーなどの基体上に、スピニングなどの常法に従って塗布される。ここで用いる溶剤は、各成分を溶解し、適当な乾燥速度を有し、溶剤が蒸発した後に均一で平滑な塗膜を与えるものであればよく、この分野で一般に用いられている溶剤が使用される。例えば、エチルセロソルブアセテート、メチルセロソルブアセテート及びプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートのようなグリコールエーテルエステル類、乳酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミル及びピルピル酸エチルのようなエステル類、アセトン、メチルイソブチルケトン、2-ヘキタンオン及びシクロヘキサノンのようなケトン類、γ-ブチrolactonのような環状エス

テル類などを挙げることができる。これらの溶剤は、それぞれ単独で、又は2種以上組み合わせて用いることができる。

【0117】基体上に塗布され、乾燥されたレジスト膜には、パターニングのための露光処理が施され、次いで脱保護基反応を促進するための加熱処理を行った後、アルカリ現像液で現像される。ここで用いるアルカリ現像液は、この分野で用いられる各種のアルカリ性水溶液であることができるが、一般には、テトラメチルアンモニウムヒドロキシドや(2-ヒドロキシエチル)トリメチルアンモニウムヒドロキシド(通称コリン)の水溶液が用いられることが多い。

【0118】

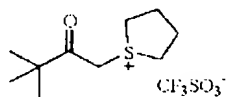
【実施例】次に実施例を挙げて、本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によってなんら限定されるものではない。例中、含有量ないし使用量を表す%及び部は、特記ないかぎり重量基準である。また重量平均分子量は、ポリスチレンを標準品として、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーにより求めた値である。

【0119】酸発生剤合成例1：酸発生剤B1の合成

(1) 四つ口フラスコにテトラヒドロチオフェン 70.17部、アセトン750部を仕込み、ここに1-ブロモピナコロン150部を滴下し、室温で24時間攪拌した。析出した結晶を濾取し、tert-ブチルメチルエーテル100部で洗浄し、乾燥することにより、3,3-ジメチルー2-オキソブチルチアシクロペンタニウム

ブロミド161.3部を得た。
(2) 四つ口フラスコに(1)で得られた3,3-ジメチルー2-オキソブチルチアシクロペンタニウムブロミド80部とアセトニトリル3200部を仕込み、ここにトリフルオロメタンスルホン酸カリウム56.33部を滴下し、室温で18時間攪拌した。析出した臭化カリウムを濾別し、濾液を濃縮した。ここに、アセトンを加え、室温で16時間攪拌し、不溶物を濾別した。この濾液をさらに濃縮し、アセトンを加えた後tert-ブチルメチルエーテルへチャージすることにより、目的物94.73部を得た。この化合物が次式で示される3,3-ジメチルー2-オキソブチルチアシクロペンタニウムトリフルオロメタンスルホナートであることを、¹H-NMR(日本電子製“GX-270”)で確認した。

【0120】



【0121】¹H-NMR(クロロホルム-d₃, 内部標準物質テトラメチルシラン): δ (ppm) 1.24 (s, 9H); 2.26-2.33 (m, 2H); 2.42-2.52 (m, 2H); 3.45-3.55 (m, 2H); 3.61-3.71 (m, 2H); 4.96 (s, 2H).

【0122】酸発生剤合成例1-2：酸発生剤B1の合成

(別法)

酸発生剤合成例1の(2)において、四つ口フラスコに(1)で得られた3,3-ジメチルー2-オキソブチルチアシクロペンタニウムブロミド169.58部とアセトニトリル3391.59部を仕込み、5℃に冷却後ここにトリフルオロメタンスルホン酸100部を滴下し、5℃で1.5時間攪拌した。溶液を270部まで濃縮し、ここに、酢酸エチル680を加え、攪拌しながらtert-ブチルメチルエーテルを300部加え、析出物を濾別した。この濾物をさらに酢酸エチル500部で溶解し、420部まで濃縮し、攪拌しながらtert-ブチルメチルエーテル50部を加え、析出物を濾過し、乾燥することで目的物156.22部を得た。

【0123】酸発生剤合成例2、3：酸発生剤B2、B3の合成

酸発生剤合成例1の(2)において、トリフルオロメタンスルホン酸カリウムの代わりにパーフルオロブタンスルホン酸カリウム、パーフルオロオクタンスルホン酸カリウムを用いる以外は、酸発生剤合成例1の(2)に準拠して実施し、それぞれ3,3-ジメチルー2-オキソブチルチアシクロペンタニウムパーフルオロブタンスルホナート、3,3-ジメチルー2-オキソブチルチアシクロペンタニウムパーフルオロオクタンスルホナートを得た。

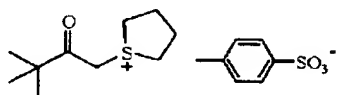
【0124】3,3-ジメチルー2-オキソブチルチアシクロペンタニウムパーフルオロブタンスルホナートの¹H-NMR(ジメチルスルホキシド-d₆, 内部標準物質テトラメチルシラン): δ (ppm) 1.15 (s, 9H); 2.13-2.23 (m, 4H); 3.33-3.38 (m, 2H); 3.47-3.54 (m, 2H); 4.85 (s, 2H).

【0125】3,3-ジメチルー2-オキソブチルチアシクロペンタニウムパーフルオロオクタンスルホナートの¹H-NMR(クロロホルム-d₃, 内部標準物質テトラメチルシラン): δ (ppm) 1.25 (s, 9H); 2.24-2.32 (m, 2H); 2.49-2.56 (m, 2H); 3.56-3.69 (m, 4H); 5.05 (s, 2H).

【0126】酸発生剤合成例4：酸発生剤B4の合成四つ口フラスコに3,3-ジメチルー2-オキソブチルチアシクロペンタニウムブロミド2.3部とアセトニトリル92部を仕込み、ここにp-トルエンスルホン酸銀2.4部をアセトニトリル7.2部に溶解させた溶液を滴下し、室温で22時間攪拌した。析出した臭化銀を濾別し、アセトニトリル30部で洗浄した。濾液と洗液を合せたものを3.3部になるまで濃縮し、ここに、アセトニトリル30部を加え、室温で2時間攪拌し、不溶物を濾別した。この濾液を2.75部になるまで濃縮した。この濃縮残渣を酢酸エチルとtert-ブチルメチルエーテルの混合溶媒から再結晶することにより、目的物0.68部を得た。この化合物が次式で示される3,3-ジメチルー2-オキソブチルチアシクロペンタニウム

ム p-トルエンスルホナートであることを、¹H-NMR (日本電子製 "GX-270") で確認した。

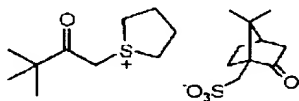
【0127】



【0128】¹H-NMR (ジメチルスルホキシド-d₆、内部標準物質テトラメチルシラン): δ (ppm) 1.12 (s, 9H); 2.05-2.29 (m, 4H); 2.29 (s, 3H); 3.32-3.56 (m, 4H); 4.89 (s, 2H); 7.12 (d, 2H); 7.48 (d, 2H).

【0129】酸発生剤合成例5: 酸発生剤B5の合成
四つ口フラスコに3,3-ジメチル-2-オキソブチルチアシクロペンタニウムブロミド2.3部とアセトニトリル9.2部を仕込み、ここにカンファースルホン酸銀2.9部をアセトニトリル8.8部に溶解させた溶液を滴下し、室温で18時間攪拌した。析出した臭化銀を濾別し、アセトニトリル3.0部で洗浄した。濾液と洗液を合せたものを3.2部になるまで濃縮し、ここに、アセトニトリル1.0部を加え、室温で2時間攪拌し、不溶物を濾別した。この濾液を2.9.2部になるまで濃縮した。この濃縮残渣を酢酸エチルとtert-ブチルメチルエーテルの混合溶媒から再結晶することにより、目的物2.46部を得た。この化合物が次式で示される3,3-ジメチル-2-オキソブチルチアシクロペンタニウムカンファースルホナートであることを、¹H-NMR (日本電子製 "GX-270") で確認した。

【0130】



【0131】¹H-NMR (ジメチルスルホキシド-d₆、内部標準物質テトラメチルシラン): δ (ppm) 0.74 (s, 3H); 1.05 (s, 3H); 1.15 (s, 9H); 1.20-1.39 (m, 2H); 1.76-1.95 (m, 3H); 2.10-2.28 (m, 5H); 2.36 (d, 1H); 2.66-2.74 (m, 1H); 2.86 (d, 1H); 3.33-3.58 (m, 4H); 4.90 (s, 2H).

【0132】樹脂合成例1: 樹脂A1の合成

メタクリル酸2-エチル-2-アダマンチル、メタクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチル、及びα-メタクリロイルオキシ-γ-ブチロラクトンを、5:2.5:2.5のモル比(20.0部:9.5部:7.3部)で仕込み、全モノマーに対して2重量倍のメチルイソブチルケトンを加えて、溶液とした。そこに、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリルを全モノマー量に対して2モル%添加し、80℃で約8時間加熱した。その後、反応液を大量のヘプタンに注いで沈殿させる操作を3回行い、精製した。その結果、重量平均分子量が約9,200の共重合体を得た。この共重合体を樹脂A1とする。

【0133】樹脂合成例2: 樹脂A2の合成

メタクリル酸2-エチル-2-アダマンチル、アクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチル、ノルボルネン及び無水マレイン酸を2:2:3:3のモル比(10.0部:9.0部:5.7部:5.9部)で仕込み、全モノマーの2重量倍のメチルイソブチルケトンを加えた後、窒素雰囲気下で80℃に昇温した。そこに、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリルを全モノマー量に対して3モル%添加し、80℃で約15時間加熱した。その後、反応液を大量のメタノールに注いで沈殿させる操作を3回行い、重量平均分子量が約12160、分散が1.90の共重合体(17.1部)を得た。この共重合体を樹脂A2とする。

【0134】樹脂合成例3: 樹脂A3の合成

メタクリル酸2-エチル-2-アダマンチル、5-メタクリロイルオキシ-2,6-ノルボルネンラクトンおよびα-メタクリロイルオキシ-γ-ブチロラクトンを2:1:1のモル比(11.1g:5.0g:3.8g)で混合し、1.4-ジオキサン50gを加え溶液とした。そこに開始剤としてアゾビスイソブチロニトリルを0.30gを加え、85℃に昇温し5時間攪拌を続けた。その後、大量のn-ヘプタンに注ぎこむことで晶析する操作を3回繰り返すことで精製したところ分子量9100、分散1.72の共重合体を得た。これを樹脂A3とする。

【0135】樹脂合成例4: 樹脂A4の合成

4口フラスコにアクリル酸1-(1-アダマンチル)-1-メチルエチル10.5g(42mmol)、アクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチル9.4g(42mmol)、2-ノルボルネン6.0g(63mmol)、無水マレイン酸6.2g(63mmol)を入れ、メチルイソブチルケトン64.2gで溶解し、30分間窒素を吹き込みバブリングした後、80℃まで昇温した。その溶液に、2,2'-アゾビス(イソブチロニトリル)1.0g(6.3mmol)をメチルイソブチルケトン16.0gで溶解した溶液を滴下し、80℃で15時間保温した。得られた反応マスを冷却し、メタノール113.4gの中に投入した。すると、白色の結晶が析出したので、濾過で結晶を取り出した。その結晶をメタノールで洗浄し、30℃で15時間減圧乾燥した。得られたアクリル酸1-(1-アダマンチル)-1-メチルエチルとアクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチルと2-ノルボルネンと無水マレイン酸の共重合体の結晶は、16.4gであり、分子量はポリスチレン換算で6900であった。これを樹脂A4とする。

【0136】樹脂合成例5: 樹脂A5の合成

(1)フラスコに、メタクリル酸2-メチル-2-アダマンチル16.4g(60.7mmol)とp-アセトキシスチレン45.4g(60.28mmol)とイソプロパノール412.3gを仕込んで窒素置換をし、75℃まで昇温した。その溶液に、ジメチル-2,2'-アゾビス(2-メチルプロピオネート)4.84g(6.02mmol)

をイソプロパノール 9.7 g に溶かしてから滴下した。75℃で約 0.5 時間、還流下で約 1.1 時間熟成した後、アセトンで希釈し、ヘプタンにチャージし、晶析させ、濾過により結晶を取り出し、得られた結晶を乾燥した。得られたメタクリル酸 2-メチル-2-アダマンチルと p-アセトキシスチレン共重合体の結晶は 5.4.2 g であった。

【0137】(2)フラスコに、上記で得られたメタクリル酸 2-メチル-2-アダマンチルと p-アセトキシスチレン共重合体 (20:80) 53.0 g (モノマー単位として 0.30 モル) と 4-ジメチルアミノピリジン 5.3 g (0.043 モル) とメタノール 159.0 g を仕込んで、還流下、20 時間熟成した。冷却後、氷酢酸 3.13 g (0.052 モル) で中和し、水にチャージし、晶析させ、濾過により結晶を取り出した。その後、結晶をアセトンに溶かし、水にチャージし、晶析させ、濾過により結晶を取り出し、この一連の操作を計 3 回繰り返した後、得られた結晶を乾燥した。得られたメタクリル酸 2-メチル-2-アダマンチルと p-ヒドロキシスチレン共重合体の結晶は 37.8 g であった。また、重量平均分子量は約 7900、分散度 1.72 (GPC 法: ポリスチレン換算) であり、共重合比は核磁気共鳴 (¹³C-NMR) 分光計により、約 20:80 と求められた。この樹脂を樹脂 A5 とする。

【0138】樹脂 A6: 4-ヒドロキシスチレン/スチレン/アクリル酸 t-ブチル (60/20/20) 共重合体、重*

樹脂: 10 部 (種類は表 1 のとおり)

酸発生剤: 種類と量は、表 1 のとおり。

クエンチャー: 2,6-ジイソプロピルピリジン 0.015 部 (実施例 6 のみ 0.008 部)

溶剤: プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート 57 部

γ-ブチロラクトン

3 部

【0142】Brewer 社製の "DUV-30J" を塗布し、215℃、60 秒の条件でベークして厚さ 1.600 Å の有機反射防止膜を形成させたシリコンウェハーに、上記のレジスト液を乾燥後の膜厚が 0.335 μm となるようにスピコートした。レジスト液塗布後は、ダイレクトホットプレート上にて表 1 に示す温度で 60 秒間プリベークした。こうしてレジスト膜を形成したウェハーに、ArF エキシマステッパ (株) ニコン製の "NSR ArF"、NA=0.55、σ=0.6 を使い、露光量を段階的に変化させてラインアンドスペースパターンを露光した。露光後は、ホットプレート上にて表 1 に示す温度で 60 秒間ポストエクスポジャーベークを行い、さらに 2.38% テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で 60 秒間のハドル現像を行った。現像後のパターンを走査型電子顕微鏡で観察し、実効感度及び解像度を調べた。 ※

* 量平均分子量 11000 (丸善石油化学 (株) 製、TSM 4)

【0139】次に、以下の酸発生剤 B1~B3、C1 及び C2 を用いてレジスト組成物を調製し、評価した例を示す。

【0140】酸発生剤 B1: 3,3-ジメチル-2-オキソブチルチアシクロペンタニウム トリフルオロメタンスルホナート

酸発生剤 B2: 3,3-ジメチル-2-オキソブチルチアシクロペンタニウム パーフルオロブタンスルホナート

酸発生剤 B3: 3,3-ジメチル-2-オキソブチルチアシクロペンタニウムパーフルオロオクタンスルホナート

酸発生剤 B4: 3,3-ジメチル-2-オキソブチルチアシクロペンタニウム p-トルエンスルホナート、

酸発生剤 B5: 3,3-ジメチル-2-オキソブチルチアシクロペンタニウム カンファースルホナート、

酸発生剤 C1: 4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロオクタンスルホナート

酸発生剤 C2: ジ p-tert-ブチルフェニルヨードニウム カンファースルホナート

【0141】実施例 1~6 及び比較例 1~4

表 1 に示す樹脂、酸発生剤を、以下に示す各成分と混合し、さらに孔径 0.2 μm のフッ素樹脂製フィルターで濾過してレジスト液を調製した。

※た、石英ガラスウェハー上に、上記のレジスト液を塗布して、上記と同様の条件でプリベークを行った後の膜厚が 0.335 μm となるようにレジスト膜を形成させ、このレジスト膜の 193 nm における透過率を分光光度計で測定した。評価結果を表 2 に示した。

【0143】実効感度: 0.18 μm のラインアンドスペースパターンが 1:1 となる最少露光量で表示した。

【0144】解像度: 実効感度の露光量で分離するラインアンドスペースパターンの最小寸法で表示した。

【0145】パターン壁面の平滑性: 孤立ラインパターンの壁面を走査型電子顕微鏡で観察し比較例よりも滑らかになっているものを○、変化の無いものを×として判断した。

【0146】

【表 1】

例 No.	樹脂	酸発生剤	プリベーク (℃)	PEB (℃)
実施例 1	A1	B1 (0.5 部) + C1 (0.2 部)	110	115

51				52
実施例 2	A1	B2(0.5部)+C1(0.2部)	110	115
実施例 3	A1	B3(0.5部)+C1(0.2部)	110	125
実施例 4	A2	B3(0.5部)+C1(0.2部)	110	125
実施例 5	A3	B3(0.5部)+C1(0.2部)	100	125
実施例 6	A4	B1(0.25部)+C1(0.2部)	110	125
比較例 1	A1	C1(0.2部)	110	125
比較例 2	A2	C1(0.2部)	110	125
比較例 3	A3	C1(0.2部)	100	125
比較例 4	A4	C1(0.2部)	100	125

【0147】

* * 【表2】

例 No.	実効感度 mJ/cm ²	解像度 μm	透過率	パターン壁面の 平滑性
実施例 1	48	0.16	68	○
実施例 2	57	0.15	68	○
実施例 3	41	0.16	67	○
実施例 4	41	0.16	67	○
実施例 5	70	0.16	68	○
実施例 6	29	0.16	65	○
比較例 1	53	0.15	64	—
比較例 2	76	0.16	64	—
比較例 3	88	0.16	65	—
比較例 4	44	0.16	67	—

【0148】表2に示されるように、実施例のレジスト組成物は、比較例にくらべてラインエッジラフネスに優れ、透過率の低下もなく、良好な感度、解像度である。

【0149】実施例7～12、比較例5、6

表1に示す樹脂、酸発生剤を、以下に示す各成分と混合し、さらに孔径0.2μmのフッ素樹脂製フィルターで濾過してレジスト液を調製した。

樹脂：13.5部（種類は表3のとおり）

酸発生剤：種類と量は、表1のとおり。

クエンチャー：トリイソプロピル47シを0.07部

溶剤：乳酸エチル 60部

【0150】実施例7～10、比較例5、6においては、Brewer社製の“DUV-30J”を塗布し、215℃、60秒の条件でバークして厚さ1600Åの有機反射防止膜を形成させたシリコンウェハーに、実施例11、12においては、Brewer社製の“DUV-42”を塗布し、215℃、60秒の条件でバークして厚さ600Åの有機反射防止膜を形成させたシリコンウェハーに、上記のレジスト液を乾燥後の膜厚が0.49μmとなるようにスピンコートした。レジスト塗布後は、ダイレクトホットプレート上にて表3の温度で60秒間ソリバークした。こうしてレジスト膜を形成したウェハーに、KrFエキシマステッ

パー〔(株)ニコン製の“NSR 2205EX12B”、NA=0.55、2/3輪帯照明〕で露光量を段階的に変化させてラインアンドスペースパターンを露光した。露光後は、ホットプレート上にて表3の温度で60秒間ポストエクスポージャーバークを行い、さらに2.38%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で60秒間のパドル現像を行った。現像後のパターンを走査型電子顕微鏡で観察し、実効感度及び解像度を調べた。また、石英ガラスウェハー上に、上記のレジスト液を塗布して、上記と同様の条件でプリバークを行った後の膜厚が0.49μmとなるようにレジスト膜を形成させ、このレジスト膜の248nmにおける透過率を分光光度計で測定した。評価結果を表4に示した。

【0151】実効感度：0.20μmのラインアンドスペースパターンが1：1となる最少露光量で表示した

【0152】解像度：実効感度の露光量で分離するラインアンドスペースパターンの最小寸法で表示した

【0153】パターン壁面の平滑性：孤立ラインパターンの壁面を走査型電子顕微鏡で観察し比較例よりも滑らかになっているものを○、変化の無いものを×として判断した

【0154】

【表3】

例 No.	樹脂	酸発生剤	ブリアータ(℃)	PEB(℃)
実施例7	A5	B2(0.35部)+C2(0.7部)	120	140
実施例8	A6	B1(0.35部)+C2(0.35部)	130	140
実施例9	A6	B2(0.35部)+C2(0.35部)	130	140
実施例10	A6	B3(0.35部)+C2(0.35部)	130	140
実施例11	A6	B4(0.35部)+C2(0.35部)	130	140
実施例12	A6	B5(0.35部)+C2(0.35部)	130	140
比較例5	A5	C2(0.7部)	120	140
比較例6	A6	C2(0.35部)	130	140

【0155】

* * 【表4】

例 No.	実効感度 mJ/cm ²	解像度 μm	透過率	パターン壁面の 平滑性
実施例7	50	0.16	72	○
実施例8	78	0.16	76	○
実施例9	82	0.16	76	○
実施例10	90	0.16	76	○
実施例11	82	0.16	75	○
実施例12	96	0.16	75	○
比較例5	48	0.16	72	—
比較例6	120	0.19	77	—

【0156】表4に示されるように、実施例のレジスト組成物は、比較例にくらべてラインエッジラフネスに優れ、透過率の低下もなく、良好な感度、解像度である。

【0157】

【発明の効果】本発明の化学増幅型ポジ型レジスト組成物は、ラインエッジラフネスが著しく改善されたレジス

トパターンを与え、またドライエッチング耐性や感度、解像度などのレジスト諸性能も良好である。したがって、この組成物は、KrFエキシマレーザーやArFエキシマレーザーなどを用いたリソグラフィに適しており、それによって高い性能のレジストパターンを与える。

フロントページの続き

(72) 発明者 釜淵 明
大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住友化学工業株式会社内

Fターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AA03 AA09 AB16
AC04 AC08 AD03 BE00 BE07
BG09 FA03 FA12 FA17
4H006 AA01 AA03 AB80